

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2004年9月23日 (23.09.2004)

PCT

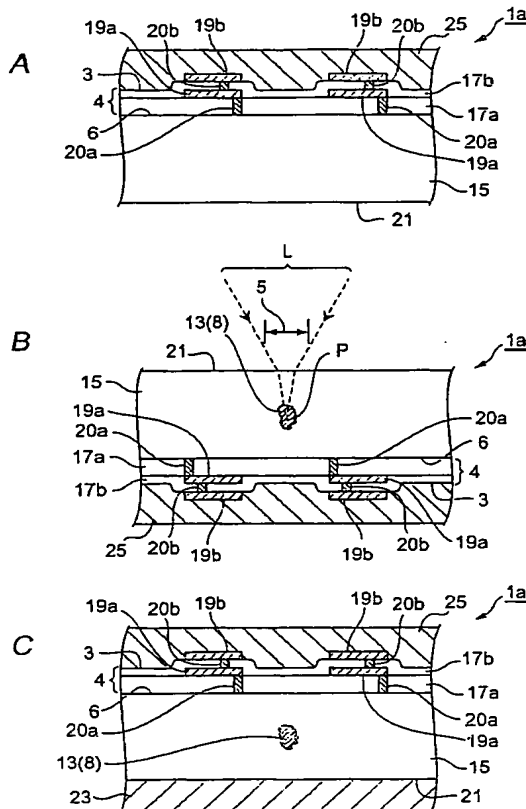
(10) 国際公開番号  
WO 2004/082006 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/301, B28D 5/00, B23K 26/38 // 101:40
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/011626
- (22) 国際出願日: 2003年9月11日 (11.09.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2003-67276 2003年3月12日 (12.03.2003) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 福満 憲志 (FUKUMITSU, Kenshi) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 福世 文嗣 (FUKUYO, Fumitsugu) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 内山 直己 (UCHIYAMA, Naoki) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都 中央区 銀座一丁目10番6号 銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

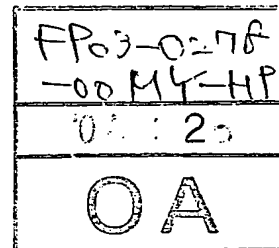
(54) Title: LASER BEAM MACHINING METHOD

(54) 発明の名称: レーザ加工方法



(57) Abstract: The invention provides a laser beam machining method characterized by comprising the steps of mounting a protective tape (25) on the surface (3) of a wafer (1a), radiating laser light (L) by using the back (21) of a wafer (1a) as a laser light incidence plane with an optical converging point (P) positioned in a substrate (15) to thereby form a melt processing region (13) for melt processing by multiphoton absorption, forming, by means of the melt processing region (13), a cutting start region (8) on the side within a predetermined distance from the laser light incidence plane along a predetermined cutting line (5) on the wafer (1a), mounting an expand tape (23) on the back (21) of the wafer (1a), and stretching the expand tape (23) to thereby separate a plurality of chip-like portions (24) from each other that are formed by the wafer (1a) being cut with the cutting start region (8) used as the starting point.

(57) 要約: 本発明は、ウエハ1aの表面3に保護テープ25を装着し、ウエハ1aの裏面21をレーザー光入射面として基板15の内部に集光点Pを合わせてレーザー光Lを照射することにより多光子吸収による熔融処理領域13を形成し、この熔融処理領域13によって、ウエハ1aの切断予定ライン5に沿ってレーザー光入射面から所定距離内側に切断起点領域8を形成し、ウエハ1aの裏面21にエキスパンドテープ23を装着し、切断起点領域8を起点としてウエハ1aが切断されることにより生じた複数のチップ状部分24を、エキスパンドテープ23を伸張させることにより互いに分離する工程を備えることを特徴とするレーザー加工方法を提供する。



WO 2004/082006 A1



ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明細書

### レーザ加工方法

#### 技術分野

【0001】 本発明は、加工方法、特にレーザを用いた加工方法に関する。

#### 5 背景技術

【0002】 近年、半導体デバイス用として $Al_2O_3$ 基板上にGaN等の半導体動作層を結晶成長させたものや、液晶表示装置用としてガラス基板上に他のガラス基板を貼り合わせたもの等、種々の積層構造を有する加工対象物を高精度に切断する技術が求められている。

10 【0003】 従来、これらの積層構造を有する加工対象物の切断には、ブレードダイシング法やダイヤモンドスクライブ法が使用されるのが一般的である。

15 【0004】 ブレードダイシング法とは、ダイヤモンドブレード等により加工対象物を切削して切断する方法である。一方、ダイヤモンドスクライブ法とは、ダイヤモンドポイントツールにより加工対象物の表面にスクライブラインを設け、このスクライブラインに沿うよう加工対象物の裏面にナイフエッジを押し当てて、加工対象物を割って切断する方法である。

20 【0005】 しかしながら、ブレードダイシング法にあっては、例えば、加工対象物が上述した液晶表示装置用のものである場合、ガラス基板と他のガラス基板との間に間隙が設けられているため、この間隙に削り屑や潤滑洗浄水が入り込んでしまうおそれがある。

25 【0006】 また、ダイヤモンドスクライブ法にあっては、加工対象物が $Al_2O_3$ 基板等の硬度の高い基板を有している場合や、或いは、加工対象物がガラス基板同士を貼り合わせたものである場合等に、加工対象物の表面だけでなく裏面にもスクライブラインを設けなければならない、この表面と裏面とに設けられたスクライブラインの位置ずれによって切断不良が生じるおそれがある。

発明の開示

【0007】 そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、上述したような問題を解決し、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても加工対象物を高精度に切断することのできるレーザ加工方法を提供することを目的とする。

5 【0008】 上記目的を達成するために、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、  
10 加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、切断起点領域を起点として加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備えることを特徴とする。

15 【0009】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、半導体基板と、半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を  
20 形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、切断起点領域を起点として加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備えることを特徴とする。

25 【0010】 これらのレーザ加工方法によれば、加工対象物の表面に保護フィルムを装着することによって、加工対象物を裏面を上にして台上に載置することができるので、加工対象物の裏面から（半導体）基板の内部にレーザ光を好適に照射することができる。そして、多光子吸収という現象により形成される改質領

域（溶融処理領域）でもって、加工対象物を切断すべき所望の切断予定ラインに沿った切断起点領域を基板の内部に形成し、この切断起点領域を起点として加工対象物を切断することができる。そして、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着してこれを伸張させることにより、切断された加工対象物の複数の部分を容易に分離することができる。すなわち、本レーザ加工方法によれば、加工対象物の表面にある積層部にレーザ光を直接照射せずに切断起点領域を形成できるとともに、切断起点領域を起点として基板を比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断された加工対象物を容易に分離することができる。従って、このレーザ加工方法によれば、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。

【0011】 ここで、基板上の積層部とは、基板の表面に堆積されたもの、基板の表面に貼り合わされたもの、或いは基板の表面に取り付けられたもの等をいい、基板に対し異種材料であるか同種材料であるかは問わない。そして、積層部には、基板に密着して設けられるものや、基板と間隙を取って設けられるもの等がある。例としては、基板上に結晶成長により形成された半導体動作層や、ガラス基板上に貼り合わされた他のガラス基板等があり、積層部は異種材料を複数層形成したものも含む。また、基板の内部とは、積層部が設けられている基板の表面上をも含む意味である。さらに、集光点とは、レーザ光が集光した箇所のことである。そして、切断起点領域は、改質領域が連続的に形成されることで形成される場合もあるし、改質領域が断続的に形成されることで形成される場合もある。

【0012】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加

工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、加工対象物に外力を印加することにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断し、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

- 5 【0013】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、加工対象物に外力を印加することにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断し、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

- 10
- 15 【0014】 これらのレーザ加工方法によれば、上述したレーザ加工方法と同様の理由により、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。また、加工対象物を複数の部分に切断する際に加工対象物に外力を印加することによって、切断起点領域を起点として加工対象物を容易に切断することができる。

- 20 【0015】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、伸張性のフィルムを伸張させるこ
- 25

とにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断するとともに加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

【0016】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、半導体基板と、半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、伸張性のフィルムを伸張させることにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断するとともに加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

【0017】 これらのレーザ加工方法によれば、上述したレーザ加工方法と同様の理由により、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。また、伸張性のフィルムを伸張させることにより、加工対象物の切断起点領域に引張応力が印加されるので、加工対象物を切断する工程と複数の部分を分離する工程とを同時に行うことができ、製造工程を削減することができる。

【0018】 また、上述した本発明に係るレーザ加工方法においては、加工対象物に切断起点領域を形成する前に、加工対象物の基板が薄くなるように加工対象物の裏面を研削することが好ましい。これによって、切断起点領域を起点としてより小さな力で、或いは特別な力を必要とせずに加工対象物を精度良く切断することができる。

【0019】 また、上述した本発明に係るレーザ加工方法においては、伸張性のフィルムを加工対象物に装着した後、保護フィルムを除去することが好ましい。これによって、切断起点領域が形成された加工対象物を離散させることなく保持することができる。或いは、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象

物の複数の部分を分離した後、保護フィルムを除去することが好ましい。これによって、加工対象物を切断してから複数の部分を取り出すまでの間、該複数の部分を保護することができる。

#### 図面の簡単な説明

- 5 図 1 は、本実施形態に係るレーザ加工方法によるレーザ加工中の加工対象物の平面図である。
- 図 2 は、図 1 に示す加工対象物の II-II 線に沿った断面図である。
- 図 3 は、本実施形態に係るレーザ加工方法によるレーザ加工後の加工対象物の平面図である。
- 10 図 4 は、図 3 に示す加工対象物の IV-IV 線に沿った断面図である。
- 図 5 が、図 3 に示す加工対象物の V-V 線に沿った断面図である。
- 図 6 は、本実施形態に係るレーザ加工方法により切断された加工対象物の平面図である。
- 図 7 は、本実施形態に係るレーザ加工方法における電界強度とクラックスポットの大きさとの関係を示すグラフである。
- 15 図 8 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 1 工程における加工対象物の断面図である。
- 図 9 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 2 工程における加工対象物の断面図である。
- 20 図 10 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 3 工程における加工対象物の断面図である。
- 図 11 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 4 工程における加工対象物の断面図である。
- 図 12 は、本実施形態に係るレーザ加工方法により切断されたシリコンウェハの一部における断面の写真を表した図である。
- 25 図 13 は、本実施形態に係るレーザ加工方法におけるレーザ光の波長とシリ



コン基板の内部の透過率との関係を示すグラフである。

図 1 4 は、本実施形態に係るレーザ加工装置の概略構成図である。

図 1 5 は、本実施形態に係るレーザ加工方法において用いられるウェハを示す斜視図である。

5 図 1 6 は、図 1 5 に示されたウェハの平面図である。

図 1 7 は、図 1 6 に示されたウェハの VI-VI 断面及び VII-VII 断面を示す拡大図である。

図 1 8 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 1 実施例を説明するためのフローチャートである。

10 図 1 9 は、図 1 4 に示されたレーザ加工装置を用いてウェハに切断起点領域を形成する方法を示すフローチャートである。

図 2 0 A-2 0 C は、第 1 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

15 図 2 1 A-2 1 C は、第 1 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

図 2 2 は、第 1 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

図 2 3 は、第 1 実施例に係るレーザ加工方法の変形例を説明するための断面図である。

20 図 2 4 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 2 実施例を説明するためのフローチャートである。

図 2 5 A-2 5 C は、第 2 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

25 図 2 6 A-2 6 C は、第 2 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

図 2 7 は、第 2 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面

図である。

図 28 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 3 実施例を説明するためのフローチャートである。

5 図 29 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 4 実施例を説明するためのフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

10 【0020】 以下、図面と共に本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。本実施形態に係るレーザ加工方法では、加工対象物の内部に多光子吸収による改質領域を形成する。そこで、このレーザ加工方法、特に多光子吸収について最初に説明する。

15 【0021】 材料の吸収のバンドギャップ  $E_G$  よりも光子のエネルギー  $h\nu$  が小さいと光学的に透明となる。よって、材料に吸収が生じる条件は  $h\nu > E_G$  である。しかし、光学的に透明でも、レーザ光の強度を非常に大きくすると  $n h\nu > E_G$  の条件 ( $n = 2, 3, 4, \dots$ ) で材料に吸収が生じる。この現象を多光子吸収という。パルス波の場合、レーザ光の強度はレーザ光の集光点のピーク  
20 パワー密度 ( $W/cm^2$ ) で決まり、例えばピークパワー密度が  $1 \times 10^8$  ( $W/cm^2$ ) 以上の条件で多光子吸収が生じる。ピークパワー密度は、(集光点におけるレーザ光の 1 パルス当たりのエネルギー)  $\div$  (レーザ光のビームスポット断面積  $\times$  パルス幅) により求められる。また、連続波の場合、レーザ光の強度はレーザ光の集光点の電界強度 ( $W/cm^2$ ) で決まる。

25 【0022】 このような多光子吸収を利用する本実施形態に係るレーザ加工の原理について、図 1 ~ 図 6 を参照して説明する。図 1 はレーザ加工中の加工対象物 1 の平面図であり、図 2 は図 1 に示す加工対象物 1 の II-II 線に沿った断面図であり、図 3 はレーザ加工後の加工対象物 1 の平面図であり、図 4 は図 3 に示す加工対象物 1 の IV-IV 線に沿った断面図であり、図 5 は図 3 に示す加工対象物 1 の V-V 線に沿った断面図であり、図 6 は切断された加工対象物 1 の平面図

である。

【0023】 図1及び図2に示すように、加工対象物1の面10には、加工対象物1を切断すべき所望の切断予定ライン5がある。切断予定ライン5は直線状に延びた仮想線である（加工対象物1に実際に線を引いて切断予定ライン5としてもよい）。本実施形態に係るレーザ加工は、多光子吸収が生じる条件で加工対象物1の内部に集光点Pを合わせてレーザ光Lを加工対象物1に照射して改質領域7を形成する。なお、集光点とはレーザ光Lが集光した箇所のことである。また、加工対象物1の面10はレーザ光が入射されるレーザ光入射面となっており、該面10においてレーザ光Lが散乱することを防ぐため、平坦かつ滑面であることが好ましい。

【0024】 レーザ光Lを切断予定ライン5に沿って（すなわち矢印A方向に沿って）相対的に移動させることにより、集光点Pを切断予定ライン5に沿って移動させる。これにより、図3～図5に示すように改質領域7が切断予定ライン5に沿って加工対象物1の内部にのみ形成され、この改質領域7でもって切断起点領域8が形成される。本実施形態に係るレーザ加工方法は、加工対象物1がレーザ光Lを吸収することにより加工対象物1を発熱させて改質領域7を形成するのではない。加工対象物1にレーザ光Lを透過させ加工対象物1の内部に多光子吸収を発生させて改質領域7を形成している。よって、加工対象物1の面10ではレーザ光Lがほとんど吸収されないので、加工対象物1の面10が熔融することはない。

【0025】 加工対象物1の切断において、切断する箇所に起点があると加工対象物1はその起点から割れるので、図6に示すように比較的小さな力で加工対象物1を切断することができる。よって、加工対象物1の面10に不必要な割れを発生させることなく加工対象物1の切断が可能となる。

【0026】 さて、本実施形態において多光子吸収により形成される改質領域としては、次の（1）～（3）がある。

(1) 改質領域が1つ又は複数のクラックを含むクラック領域の場合

基板（例えばサファイア、ガラス、またはLiTaO<sub>3</sub>からなる圧電材料）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が $1 \times 10^8$  (W/cm<sup>2</sup>)以上で且つパルス幅が1μs以下の条件でレーザー光を照射する。このパルス幅の大きさは、多光子吸収を生じさせつつ基板の面に余計なダメージを与えずに、基板の内部にのみクラック領域を形成できる条件である。これにより、基板の内部には多光子吸収による光学的損傷という現象が発生する。この光学的損傷により基板の内部に熱ひずみが誘起され、これにより基板の内部にクラック領域が形成される。電界強度の上限値としては、例えば $1 \times 10^{12}$  (W/cm<sup>2</sup>)である。パルス幅は例えば1ns～200nsが好ましい。

【0027】 本発明者は、電界強度とクラックの大きさとの関係を実験により求めた。実験条件は下記の通りである。

(A) 基板：パイレックス（登録商標）ガラス（厚さ700μm）

(B) レーザ

光源：半導体レーザー励起Nd：YAGレーザー

波長：1064nm

レーザー光スポット断面積： $3.14 \times 10^{-8}$  cm<sup>2</sup>

発振形態：Qスイッチパルス

繰り返し周波数：100kHz

パルス幅：30ns

出力：出力<1mJ/パルス

レーザー光品質：TEM<sub>00</sub>

偏光特性：直線偏光

(C) 集光用レンズ

レーザー光波長に対する透過率：60パーセント

(D) 基板が載置される載置台の移動速度：100mm/秒

【0028】 なお、レーザ光品質がTEM<sub>00</sub>とは、集光性が高くレーザ光の波  
長度まで集光可能を意味する。

【0029】 図7は上記実験の結果を示すグラフである。横軸はピークパワー  
密度であり、レーザ光がパルスレーザ光なので電界強度はピークパワー密度で表  
5 される。縦軸は1パルスのレーザ光により基板の内部に形成されたクラック部分  
(クラックスポット)の大きさを示している。クラックスポットが集まりクラッ  
ク領域となる。クラックスポットの大きさは、クラックスポットの形状のうち最  
大の長さとなる部分の大きさである。グラフ中の黒丸で示すデータは集光用レン  
ズ(C)の倍率が100倍、開口数(NA)が0.80の場合である。一方、グ  
10 ラフ中の白丸で示すデータは集光用レンズ(C)の倍率が50倍、開口数(N  
A)が0.55の場合である。ピークパワー密度が $10^{11}$  (W/cm<sup>2</sup>)程度か  
ら基板の内部にクラックスポットが発生し、ピークパワー密度が大きくなるに従  
いクラックスポットも大きくなることが分かる。

【0030】 次に、本実施形態に係るレーザ加工において、クラック領域形成  
15 による加工対象物の切断のメカニズムについて図8～図11を用いて説明する。  
図8に示すように、多光子吸収が生じる条件で加工対象物1の内部に集光点Pを  
合わせてレーザ光Lを加工対象物1に照射して切断予定ラインに沿って内部にク  
ラック領域9を形成する。クラック領域9は1つ又は複数のクラックを含む領域  
である。このクラック領域9でもって切断起点領域が形成される。図9に示すよ  
20 うに、人為的な力(例えば引張応力)を加工対象物1に印加することにより、ク  
ラック領域9を起点として(すなわち、切断起点領域を起点として)クラックが  
さらに成長し、図10に示すようにクラックが加工対象物1の両面に到達し、図  
11に示すように加工対象物1が割れることにより加工対象物1が切断される。

【0031】 (2) 改質領域が熔融処理領域の場合

25 基板(例えばシリコンのような半導体材料)の内部に集光点を合わせて、集光  
点における電界強度が $1 \times 10^8$  (W/cm<sup>2</sup>)以上で且つパルス幅が1 $\mu$ s以下の

条件でレーザー光を照射する。これにより基板の内部は多光子吸収によって局所的に加熱される。この加熱により基板の内部に熔融処理領域が形成される。熔融処理領域とは一旦熔融後再固化した領域や、まさに熔融状態の領域や、熔融状態から再固化する状態の領域であり、相変化した領域や結晶構造が変化した領域ということもできる。また、熔融処理領域とは単結晶構造、非晶質構造、多結晶構造において、ある構造が別の構造に変化した領域ということもできる。つまり、例えば、単結晶構造から非晶質構造に変化した領域、単結晶構造から多結晶構造に変化した領域、単結晶構造から非晶質構造及び多結晶構造を含む構造に変化した領域を意味する。基板がシリコン単結晶構造の場合、熔融処理領域は例えば非晶質シリコン構造である。電界強度の上限値としては、例えば $1 \times 10^{12}$  (W/cm<sup>2</sup>) である。パルス幅は例えば1 ns ~ 200 ns が好ましい。

【0032】 本発明者は、シリコンウェハの内部で熔融処理領域が形成されることを実験により確認した。実験条件は次の通りである。

(A) 基板：シリコンウェハ（厚さ350 $\mu$ m、外径4インチ）

15 (B) レーザ

光源：半導体レーザー励起Nd：YAGレーザー

波長：1064 nm

レーザー光スポット断面積：3.14 $\times 10^{-8}$  cm<sup>2</sup>

発振形態：Qスイッチパルス

20 繰り返し周波数：100 kHz

パルス幅：30 ns

出力：20 $\mu$ J / パルス

レーザー光品質：TEM<sub>00</sub>

偏光特性：直線偏光

25 (C) 集光用レンズ

倍率：50倍

N. A. : 0. 55

レーザ光波長に対する透過率 : 60パーセント

(D) 基板が載置される載置台の移動速度 : 100mm/秒

5 【0033】 図12は、上記条件でのレーザ加工により切断されたシリコンウェハの一部における断面の写真を表した図である。シリコンウェハ11の内部に溶融処理領域13が形成されている。なお、上記条件により形成された溶融処理領域13の厚さ方向の大きさは100 $\mu$ m程度である。

10 【0034】 溶融処理領域13が多光子吸収により形成されたことを説明する。図13は、レーザ光の波長とシリコン基板の内部の透過率との関係を示すグラフである。ただし、シリコン基板の表面側と裏面側それぞれの反射成分を除去し、内部のみの透過率を示している。シリコン基板の厚さtが50 $\mu$ m、100 $\mu$ m、200 $\mu$ m、500 $\mu$ m、1000 $\mu$ mの各々について上記関係を示した。

15 【0035】 例えば、Nd:YAGレーザの波長である1064nmにおいて、シリコン基板の厚さが500 $\mu$ m以下の場合、シリコン基板の内部ではレーザ光が80%以上透過することが分かる。図12に示すシリコンウェハ11の厚さは350 $\mu$ mなので、多光子吸収による溶融処理領域13をシリコンウェハ11の中心付近に形成すると、シリコンウェハ11の表面から175 $\mu$ mの部分に形成される。この場合の透過率は、厚さ200 $\mu$ mのシリコンウェハを参考にすると、90%以上なので、レーザ光がシリコンウェハ11の内部で吸収されるのは僅か

20 であり、ほとんどが透過する。このことは、シリコンウェハ11の内部でレーザ光が吸収されて、溶融処理領域13がシリコンウェハ11の内部に形成（つまりレーザ光による通常の加熱で溶融処理領域が形成）されたものではなく、溶融処理領域13が多光子吸収により形成されたことを意味する。

25 【0036】 なお、シリコンウェハは、溶融処理領域でもって形成される切断起点領域を起点として断面方向に向かって割れを発生し、その割れがシリコンウェハの両面に到達することにより、結果的に切断される。発明者らの考察によれ

ば、熔融処理領域を起点とした亀裂が生じるのは、熔融処理領域とそれ以外の領域との物性的な違いによってシリコンウェハの内部に歪みが生じ易くなる為だと考えられる。また、図12に示された写真からも判るように、熔融処理領域13の上下には尖頭状の熔融痕が存在する。この熔融痕によって、熔融処理領域を起

5 点とした亀裂が精度良くシリコンウェハの両面に到達するものと考えられる。また、熔融処理領域はシリコンウェハの内部のみに形成され、切断後の切断面には、図12のように内部にのみ熔融処理領域が形成されている。基板の内部に熔融処理領域でもって切断起点領域を形成すると、切断時、切断起点領域ラインから外れた不必要な割れが生じにくいので、切断制御が容易となる。

10 【0037】 (3) 改質領域が屈折率変化領域の場合

基板（例えばガラス）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が  $1 \times 10^8$  (W/cm<sup>2</sup>) 以上で且つパルス幅が1 ns以下の条件でレーザー光を照射する。パルス幅を極めて短くして、多光子吸収を基板の内部に起こさせると、多光子吸収によるエネルギーが熱エネルギーに転化せずに、基板の内部にはイオン価数変化、結晶化又は分極配向等の永続的な構造変化が誘起されて屈折率変化

15 領域が形成される。電界強度の上限値としては、例えば  $1 \times 10^{12}$  (W/cm<sup>2</sup>) である。パルス幅は例えば1 ns以下が好ましく、1 ps以下がさらに好ましい。

【0038】 以上、多光子吸収により形成される改質領域として(1)～(3)の場合を説明したが、加工対象物の結晶構造やその劈開性を考慮して切断起点領域を次のように形成すれば、その切断起点領域を起点として、より一層小さな力で、しかも精度良く加工対象物を切断することが可能になる。

【0039】 すなわち、シリコンなどのダイヤモンド構造の単結晶半導体からなる基板の場合は、(111)面(第1劈開面)や(110)面(第2劈開面)に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。また、GaAsなどの閃

25 亜鉛鉱型構造のIII-V族化合物半導体からなる基板の場合は、(110)面に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。さらに、サファイア(A1



$2O_3$ ) などの六方晶系の結晶構造を有する基板の場合は、(0001)面(C面)を主面として(1120)面(A面)或いは(1100)面(M面)に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。

5 【0040】 なお、基板として例えば円盤状のウェハを切断する場合、上述した切断起点領域を形成すべき方向(例えば、単結晶シリコン基板における(111)面に沿った方向)、或いは切断起点領域を形成すべき方向に直交する方向に沿ってウェハにオリエンテーションフラットを形成すれば、そのオリエンテーションフラットを基準とすることで、切断起点領域を形成すべき方向に沿った切断起点領域を容易且つ正確にウェハに形成することが可能になる。

10 【0041】 次に、上述したレーザ加工方法に使用されるレーザ加工装置について、図14を参照して説明する。図14はレーザ加工装置100の概略構成図である。

15 【0042】 レーザ加工装置100は、レーザ光Lを発生するレーザ光源101と、レーザ光Lの出力やパルス幅等を調節するためにレーザ光源101を制御するレーザ光源制御部102と、レーザ光Lの反射機能を有しかつレーザ光Lの光軸の向きを90°変えるように配置されたダイクロイックミラー103と、ダイクロイックミラー103で反射されたレーザ光Lを集光する集光用レンズ105と、集光用レンズ105で集光されたレーザ光Lが照射される加工対象物1が載置される載置台107と、載置台107をX軸方向に移動させるためのX軸ステージ109と、載置台107をX軸方向に直交するY軸方向に移動させるためのY軸ステージ111と、載置台107をX軸及びY軸方向に直交するZ軸方向に移動させるためのZ軸ステージ113と、これら3つのステージ109、111、113の移動を制御するステージ制御部115とを備える。

20 【0043】 この集光点PのX(Y)軸方向の移動は、加工対象物1をX(Y)軸ステージ109(111)によりX(Y)軸方向に移動させることにより行う。Z軸方向は、加工対象物1の面10と直交する方向なので、加工対象物

1に入射するレーザー光Lの焦点深度の方向となる。よって、Z軸ステージ113をZ軸方向に移動させることにより、加工対象物1の内部にレーザー光Lの集光点Pを合わせるができる。

5 【0044】 レーザ光源101はパルスレーザー光を発生するNd:YAGレーザーである。レーザー光源101に用いることができるレーザーとして、この他、Nd:YVO<sub>4</sub>レーザー、Nd:YLFレーザーやチタンサファイアレーザーがある。本実施形態では、加工対象物1の加工にパルスレーザー光を用いているが、多光子吸収を起こさせることができるなら連続波レーザー光でもよい。

10 【0045】 レーザ加工装置100はさらに、載置台107に載置された加工対象物1を可視光線により照明するために可視光線を発生する観察用光源117と、ダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105と同じ光軸上に配置された可視光用のビームスプリッタ119とを備える。ビームスプリッタ119と集光用レンズ105との間にダイクロイックミラー103が配置されている。ビームスプリッタ119は、可視光線の約半分を反射し残りの半分を透過する機能を有しかつ可視光線の光軸の向きを90°変えるように配置されている。観察用光源117から発生した可視光線はビームスプリッタ119で約半分が反射され、この反射された可視光線がダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105を透過し、加工対象物1の切断予定ライン5等を含む面10を照明する。

15 【0046】 レーザ加工装置100はさらに、ビームスプリッタ119、ダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105と同じ光軸上に配置された撮像素子121及び結像レンズ123を備える。撮像素子121としては例えばCCDカメラがある。切断予定ライン5等を含む面10を照明した可視光線の反射光は、集光用レンズ105、ダイクロイックミラー103、ビームスプリッタ119を透過し、結像レンズ123で結像されて撮像素子121で撮像され、撮像データとなる。

25 【0047】 レーザ加工装置100はさらに、撮像素子121から出力された

撮像データが入力される撮像データ処理部125と、レーザ加工装置100全体を制御する全体制御部127と、モニタ129とを備える。撮像データ処理部125は、撮像データを基にして観察用光源117で発生した可視光の焦点を加工対象物1の面10上に合わせるための焦点データを演算する。この焦点データを基にしてステージ制御部115がZ軸ステージ113を移動制御することにより、可視光の焦点が加工対象物1の面10に合うようにする。よって、撮像データ処理部125はオートフォーカスユニットとして機能する。また、撮像データ処理部125は、撮像データを基にして面10の拡大画像等の画像データを演算する。この画像データは全体制御部127に送られ、全体制御部で各種処理がなされ、モニタ129に送られる。これにより、モニタ129に拡大画像等が表示される。

【0048】 全体制御部127には、ステージ制御部115からのデータ、撮像データ処理部125からの画像データ等が入力し、これらのデータも基にしてレーザ光源制御部102、観察用光源117及びステージ制御部115を制御することにより、レーザ加工装置100全体を制御する。よって、全体制御部127はコンピュータユニットとして機能する。

【0049】 次に、上述したレーザ加工装置100を用いた、本実施形態に係るレーザ加工方法について説明する。図15は、本実施形態に係るレーザ加工方法における加工対象物であるウェハ1aを示す斜視図である。また、図16は、図15に示されたウェハ1aの底面図である。また、図17は、図16に示されたウェハ1aのVI-VI断面及びVII-VII断面を示す拡大図である。

【0050】 図15～図17を参照すると、ウェハ1aは、平板状であり略円盤状を呈している。図16を参照すると、ウェハ1aの裏面21には縦横に交差する複数の切断予定ライン5が設定されている。切断予定ライン5は、ウェハ1aを複数のチップ状部分に切断するために想定される仮想線である。この切断予定ライン5は、例えばウェハ1aの劈開面に沿って想定されるとよい。

【0051】 また、ウェハ1aは、オリエンテーションフラット（以下「O

F」 という) 19を有している。本実施形態では、OF19は縦横に交差する切断予定ライン5のうちの一方向と平行な方向を長手方向として形成されている。OF19は、ウェハ1aを切断予定ライン5に沿って切断する際に、切断方向を容易に判別する目的で設けられている。

- 5 【0052】 また、図17を参照すると、ウェハ1aは、半導体(Si)からなる基板15と、基板15の表面6上に積層された積層部4を備えている。積層部4は、絶縁性材料(SiO<sub>2</sub>)からなる層間絶縁層17a及び17b、並びに金属(W)からなる第1の配線層19a及び第2の配線層19bを有している。
- 10 層間絶縁層17aは基板15の表面6上に積層されており、表面6上に複数互いに分割されて設定された素子形成領域上に第1の配線層19aが積層されている。第1の配線層19a及び基板15は、層間絶縁層17aを貫通するように設けられたプラグ20aによって互いに電氣的に接続されている。層間絶縁層17bは層間絶縁層17a及び第1の配線層19a上に積層されており、層間絶縁層17b上であって第1の配線層19aに対応する領域に第2の配線層19bが積層されている。第2の配線層19b及び第1の配線層19aは、層間絶縁層17bを貫通するように設けられたプラグ20bによって互いに電氣的に接続されている。
- 15

- 【0053】 層間絶縁層17b上であって第2の配線層19b同士の間にある領域には、切断予定ライン5が想定される。この切断予定ライン5においては、層間絶縁層17bの表面(すなわち、ウェハ1aの表面3)が平坦かつ滑面となっている。
- 20

【0054】 (第1の実施例)

【0055】 図18及び図19は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第1実施例を説明するためのフローチャートである。また、図20～図22は、本実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハ1aの断面図である。

- 25 【0056】 図18を参照すると、まず、ウェハ1aの表面3に積層部4を保護するための保護フィルムとして保護テープ25を装着する(S1、図20A)。

保護テープ 25 の材料としては、積層部 4 を保護する緩衝効果を有しており積層部 4 の動作特性に影響がなければ様々な材料を用いることができる。本実施形態では、保護テープ 25 の材料として、衝撃を吸収するとともに紫外線を照射することにより除去することが可能な材料を選択する。

5 【0057】 続いて、ウェハ 1 a の基板 15 の内部に、切断予定ライン 5 に沿って切断起点領域 8 を形成する (S 3、図 20B)。ここで、図 20B に示されるウェハ 1 a は、表面 3 が図の下方になるように描かれている。すなわち、ウェハ 1 a の裏面 21 における切断予定ライン 5 に対応する領域をレーザ光入射面として基板 15 の内部の集光点 P へレーザ光 L を照射することにより、基板 15 の  
10 内部に改質領域として熔融処理領域 13 を形成する。この熔融処理領域 13 が、ウェハ 1 a を切断する際の切断起点領域 8 となる。

【0058】 ここで、図 19 は、図 14 に示されたレーザ加工装置 100 を用いてウェハ 1 a に切断起点領域 8 を形成する方法を示すフローチャートである。なお、本実施形態において、ウェハ 1 a は、レーザ加工装置 100 の載置台 10  
15 7 に、裏面 21 が集光用レンズ 105 と対向するように配置される。すなわち、レーザ光 L は、ウェハ 1 a の裏面 21 から入射される。

【0059】 図 14 及び図 19 を参照すると、まず、基板 15 の光吸収特性を図示しない分光光度計等により測定する。この測定結果に基づいて、基板 15 に対して透明な波長又は吸収の少ない波長のレーザ光 L を発生するレーザ光源 10  
20 1 を選定する (S 101)。

【0060】 続いて、基板 15 の厚さ、材質、及び屈折率等を考慮して、ウェハ 1 a の Z 軸方向の移動量を決定する (S 103)。これは、ウェハ 1 a の裏面 21 から所定距離内側の所望の位置にレーザ光 L の集光点 P を合わせるために、ウェハ 1 a の裏面 21 に位置するレーザ光 L の集光点 P を基準としたウェハ 1 a  
25 の Z 軸方向の移動量である。この移動量は全体制御部 127 に入力される。

【0061】 ウェハ 1 a をレーザ加工装置 100 の載置台 107 にウェハ 1 a

の裏面21が集光用レンズ105側と対向するよう載置する。このとき、積層部4が設けられているウェハ1aの表面3には保護テープ25が装着されているので、ウェハ1aの表面3側を下にして載置台107に載置しても何ら問題ない。そして、観察用光源117から可視光を発生させてウェハ1aの裏面21を照明する(S105)。照明されたウェハ1aの裏面21を撮像素子121により撮像する。撮像素子121により撮像された撮像データは撮像データ処理部125に送られる。この撮像データに基づいて撮像データ処理部125は、観察用光源117の可視光の焦点がウェハ1aの裏面21に位置するような焦点データを演算する(S107)。

10 【0062】 この焦点データはステージ制御部115に送られる。ステージ制御部115は、この焦点データを基にしてZ軸ステージ113をZ軸方向の移動させる(S109)。これにより、観察用光源117の可視光の焦点がウェハ1aの裏面21に位置する。なお、撮像データ処理部125は撮像データに基づいて、切断予定ライン5を含む裏面21の拡大画像データを演算する。この拡大画像データは全体制御部127を介してモニタ129に送られ、これによりモニタ129に切断予定ライン5付近の拡大画像が表示される。

15 【0063】 全体制御部127には予めステップS103で決定された移動量データが入力されており、この移動量データがステージ制御部115に送られる。ステージ制御部115はこの移動量データに基づいて、レーザ光Lの集光点Pの位置がウェハ1aの裏面21から所定距離内側となるように、Z軸ステージ113によりウェハ1aをZ軸方向に移動させる(S111)。

20 【0064】 続いて、レーザ光源101からレーザ光Lを発生させて、レーザ光Lをウェハ1aの裏面21に照射する。レーザ光Lの集光点Pは基板15の内部に位置しているので、改質領域である熔融処理領域13は基板15の内部にのみ形成される。そして、切断予定ライン5に沿うようにX軸ステージ109やY軸ステージ111を移動させて熔融処理領域13を複数形成するか、あるいは切

25

断予定ライン5に沿って連続して熔融処理領域13を形成することにより、切断  
予定ライン5に沿う切断起点領域8を基板15の内部に形成する(S113)。

5 【0065】 再び図18を参照すると、ウェハ1aの裏面21に伸張性のフィルムであるエキスパンドテープ23を装着する(S5、図20C)。エキスパンドテープ23は、例えば伸張方向に力を加えることによって伸びる材料からなり、後の工程において、ウェハ1aをチップ状に分離させるために用いられる。エキスパンドテープ23としては、伸張方向に力を加えることによって伸びるもの以外にも例えば加熱により伸びるものでもよい。

10 【0066】 続いて、切断起点領域8に沿ってウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断する(S7、図21A)。すなわち、ウェハ1aの裏面21に装着されたエキスパンドテープ23の上から切断起点領域8にあわせてナイフエッジ33を当て、ウェハ1aに曲げ応力を印加することにより切断起点領域8を起点としてウェハ1aを割断(ブレーキング)する。このとき、ウェハ1a内部には切断起点領域8から表面3及び裏面21へ達する亀裂18が生じ、基板15が切  
15 断されると同時に、層間絶縁層17a及び17bも切断される。ウェハ1aに応力を印加する手段としては、ナイフエッジ33以外にも例えばブレーキング装置、ローラー装置などがある。また、ウェハ1aの表面3や裏面21にその面が熔融しないエネルギーにてウェハ1aに対して吸収性を有するレーザ光を照射すること  
20 で切断起点領域8を起点として亀裂が生じるような熱応力を発生させて切断してもよい。また、ウェハ1aの表面3に装着された保護テープ25の上からナイフエッジ33等を当てて曲げ応力を印加してもよい。

【0067】 続いて、ウェハ1aの表面3に装着された保護テープ25に紫外線Vを照射する(S9、図21B)。保護テープ25に紫外線Vを照射することによって、保護テープ25を除去可能な状態とする。そして、保護テープ25を  
25 ウェハ1aの表面3から剥離する(S11、図21C)。なお、保護テープ25の剥離はウェハ1aを切断する工程(S7)の前に行っても良い。

【0068】 続いて、ウェハ1 aを個々のチップ状部分2 4に分離する（S 1 3、図2 2）すなわち、エキスパンドテープ2 3を伸張させることにより複数のチップ状部分2 4の間に間隔2 6をあける。こうすることにより、複数のチップ状部分2 4のそれぞれをピックアップし易くなる。

5 【0069】 以上説明したように、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1 aの表面3に保護テープ2 5を装着することによって、ウェハ1 aを裏面2 1を上にして載置台1 0 7上に載置することができるので、ウェハ1 aの裏面2 1から基板1 5の内部にレーザ光Lを好適に照射することができる。

10 【0070】 そして、多光子吸収という現象により形成される改質領域でもって、ウェハ1 aを切断すべき所望の切断予定ライン5に沿った切断起点領域8を基板1 5の内部に形成し、この切断起点領域8を起点としてウェハ1 aを切断することができる。そして、ウェハ1 aの裏面2 1にエキスパンドテープ2 3を装着してこれを伸張させることにより、切断されたウェハ1 aの複数のチップ状部分2 4を容易に分離することができる。

15 【0071】 すなわち、本実施例に係るレーザ加工方法によれば、ウェハ1 aの表面3にある積層部4にレーザ光Lを直接照射せずに切断起点領域8を形成できるので、レーザ光Lによる積層部4の損傷を防止することができる。また、基板1 5内部に切断起点領域8を形成することにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1 aを比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断されたウェハ1 a  
20 を容易に分離することができる。従って、このレーザ加工方法によれば、ウェハ1 aが積層部4を有する場合においてもウェハ1 aを高精度に切断することができる。

25 【0072】 また、本実施例に係るレーザ加工方法によれば、従来のブレードダイシング法などと比べてチップ状部分2 4の間のダイシング幅を格段に小さくすることができる。そして、そのようにダイシング幅を小さくした場合、個々のチップ状部分2 4同士の間隔を小さくし、より多くのチップ状部分2 4を取り出



すことが可能になる。

【0073】 また、積層部4の構成材料やレーザ光Lの照射条件などによっては、積層部4の素子形成領域にレーザ光Lが照射されないように考慮する必要が生じる場合がある。特に本方法では多光子吸収現象を利用するためにレーザ光Lを急激に絞り込んでいるので、積層部4の素子形成領域にレーザ光Lが照射されないようにしつつ表面3からレーザ光Lを照射することが困難な場合がある。また、一般的に、ウェハの素子形成領域間には素子用に積層された半導体層が存在することが多い。或いは、メモリや集積回路素子などにおいては素子形成領域間にTEG (Test Element Group) 等の機能素子が形成されている場合もある。

5 これらのような場合に、本実施例に係るレーザ加工方法を用いれば、積層部4が設けられていない裏面21からレーザ光Lを照射して基板15の内部に切断起点領域8を好適に形成することができる。

【0074】 また、本実施例に係るレーザ加工方法では、ウェハ1aにナイフエッジ33等による外力を印加することにより切断起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断している。これによって、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを容易に切断することができる。

15

【0075】 また、本実施例に係るレーザ加工方法では、エキスパンドテープ23をウェハ1aに装着した後に、保護テープ25を除去している。これによって、切断起点領域8が形成されたウェハ1aを個々のチップ状部分24に離散させることなく保持することができる。

20

【0076】 図23は、本実施例に係るレーザ加工方法の変形例を説明するための断面図である。本変形例では、基板15の内部において、基板15の厚さ方向に複数の熔融処理領域13を形成する。熔融処理領域13をこのように形成するには、図19に示されたフローチャートのステップS111 (ウェハをZ軸方向に移動) とステップS113 (改質領域の形成) とを交互に複数回行うとよい。

25

また、ウェハ1aをZ軸方向に移動するのと改質領域の形成とを同時に行うこと

により、基板15の厚さ方向に連続して熔融処理領域13を形成してもよい。

本変形例のように熔融処理領域13を形成することにより、基板15の厚さ方向に延びた切断起点領域8を形成することができる。従って、ウェハ1aをより小さな力で割って切断することができる。さらに、基板15の厚さ方向に熔融処理領域13による亀裂を成長させれば、外部からの力を必要とせずウェハ1aを分離することもできる。

(第2の実施例)

【0077】 図24は、本実施形態によるレーザ加工方法の第2実施例を示すフローチャートである。また、図25～図27は、本実施例を説明するためのウェハ1aの断面図である。本実施例と上述した第1実施例との相違点は、(1) 基板15が薄くなるように研削する点、(2) ナイフエッジ33等を用いたプレーキングを行わない点、(3) ウェハ1aを複数のチップ状部分24に分離した後、保護テープ25を剥離する点、の3点である。

【0078】 図24を参照すると、まず、ウェハ1aの表面3に保護テープ25を装着する(S21、図25A)。この工程は、第1実施例におけるステップS1と同様なので、詳細な説明を省略する。

【0079】 続いて、ウェハ1aの裏面21を研削する(S23、図25B)。このとき、基板15の厚さを例えば30 $\mu$ m～50 $\mu$ mまで薄くなるように研削(グランド)する。また、次の工程においてレーザ光Lを裏面21から好適に入射させるために、研削後の裏面21が平坦かつ滑面となるように裏面21を研削するとよい。

【0080】 続いて、ウェハ1aの基板15の内部に、切断予定ライン5に沿って切断起点領域8を形成する(S25、図25C)。続いて、ウェハ1aの研削後の裏面21に、エキスパンドテープ23を装着する(S27、図26A)。これらの工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップS3及びS5と同様なので、詳細な説明を省略する。

【0081】 続いて、エキスパンドテープ23を伸張させることにより、切断  
5 起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断するととも  
に、個々のチップ状部分24を互いに分離させる（S29、図26B）。このと  
き、前述したステップS23において基板15が十分に薄くなるように研削した  
ので、エキスパンドテープ23を伸張させることによる引張応力のみによって、  
切断起点領域8を起点としてウェハ1aが切断される。そして、エキスパンドテ  
ープ23をそのまま伸張させることにより複数のチップ状部分24の間に間隔2  
6をあける。

【0082】 続いて、保護テープ25に紫外線を照射し（S31、図26C）、  
10 保護テープ25をウェハ1aの表面3から剥離する（S33、図27）。これら  
の工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップS9及びS11と同様  
なので、詳細な説明を省略する。なお、保護テープ25の剥離はエキスパンドテ  
ープ23を伸張させウェハ1aを切断する工程（S29）の前に行っても良い。

【0083】 本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第1実施例  
15 と同様に、ウェハ1aの表面3にある積層部4にレーザ光Lを直接照射せずに切  
断起点領域8を形成できるので、レーザ光Lによる積層部4の損傷を防止するこ  
とができる。また、基板15内部に切断起点領域8を形成することにより、切断  
起点領域8を起点としてウェハ1aを比較的小さな力で精度良く割って切断し、  
切断されたウェハ1aを容易に分離することができる。従って、このレーザ加工  
20 方法によれば、ウェハ1aが積層部4を有する場合においてもウェハ1aを高精  
度に切断することができる。

【0084】 また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1aの  
基板15が薄くなるようにウェハ1aの裏面21を研削している。これによって、  
切断起点領域8を起点としてより小さな力で、或いは特別な力を必要とせず  
25 ウェハ1aを切断することができる。また、基板15が比較的厚い場合に比べてよ  
り精度良くウェハ1aを切断することができる。

【0085】 また、本実施例に係るレーザー加工方法においては、ウェハ1aの裏面21に装着したエキスパンドテープ23を伸張させることにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断するとともに複数のチップ状部分24を互いに分離している。エキスパンドテープ23を伸張させる際には、ウェハ1aの切断起点領域8に引張応力が印加されるので、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを好適に切断することができる。従って、本実施形態によれば、ウェハ1aを切断する工程と、複数のチップ状部分24を互いに分離する工程とを同時に行うことができるので、製造工程を削減することができる。

10 【0086】 また、本実施例に係るレーザー加工方法においては、ウェハ1aの裏面21をレーザー光入射面としてレーザー光Lを照射している。発明者らの実験によれば、熔融処理領域13などの改質領域は、基板15内部のうちレーザー光入射面側に偏って形成される傾向がある。従って、本レーザー加工方法では、エキスパンドテープ25が装着される裏面21側に偏って切断起点領域13が形成される傾向がある。一方、エキスパンドテープ23を伸張させると、基板15の裏面21付近のほうが表面6付近に比べてより大きな引張応力を印加される。従って、基板15内部において切断起点領域8が裏面21側に偏っていれば、エキスパンドテープ25を伸張させることによる引張応力をより効果的に切断起点領域8に作用させることができる。以上のことから、本実施例に係るレーザー加工方法によれば、切断起点領域8に引張応力をより効果的に作用させ、より小さな力でウェハ1aを切断することができる。

15 【0087】 また、本実施例に係るレーザー加工方法においては、エキスパンドテープ23を伸張させることによりウェハ1aの複数のチップ状部分24を分離した後に、保護テープ25を除去している。これによって、ウェハ1aを切断してから複数のチップ状部分24を取り出すまでの間、該複数のチップ状部分24を保護することができる。



と同様の理由により、ウェハ1 aが積層部4を有する場合においてもウェハ1 aを高精度に切断することができる。

【0094】 また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第2実施例と同様に、エキスパンドテープ23を伸張させることにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1 aを複数のチップ状部分24に切断するとともに複数のチップ状部分24を互いに分離している。これによって、ウェハ1 aを切断する工程と、複数のチップ状部分24を互いに分離する工程とを同時に行うことができるので、製造工程を削減することができる。

【0095】 (第4の実施例)

10 【0096】 図29は、本実施形態によるレーザ加工方法の第4実施例を示すフローチャートである。本実施例と上述した第1実施例との相違点は、(1)基板15が薄くなるように研削する点、の1点である。本変形例では、第1実施例にて示した図20～図22と、第2実施例にて示した図25とを参照しながら説明する。

15 【0097】 図29を参照すると、まず、ウェハ1 aの表面3に保護テープ25を装着する(S61、図20A)。この工程は、第1実施例におけるステップS1と同様なので、詳細な説明を省略する。続いて、ウェハ1 aの裏面21を研削する(S63、図25B)。この工程は、第2実施例におけるステップS23と同様なので、詳細な説明を省略する。続いて、ウェハ1 aの基板15の内部に、  
20 切断予定ライン5に沿って切断起点領域8を形成する(S65、図25C)。この工程は、第1実施例におけるステップS3と同様なので、詳細な説明を省略する。

【0098】 続いて、ウェハ1 aの裏面21に、エキスパンドテープ23を装着し(S67、図20C)、ウェハ1 aに外力を印加することにより切断起点領域8に沿ってウェハ1 aを複数のチップ状部分24に切断し(S69、図21A)、保護テープ25に紫外線を照射し(S71、図21B)、保護テープ25

をウェハ1 a の表面3から剥離し(S 7 3、図2 1 C)、エキスパンドテープ2 3を伸張させることにより、ウェハ1 aの個々のチップ状部分2 4を互いに分離させる(S 7 5、図2 2)。これらの工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップS 5～S 1 3と同様なので、詳細な説明を省略する。ただし、本実施例ではステップS 6 3においてウェハ1 aの裏面2 1を研削しているので、基板1 5の厚さは図2 0 C、図2 1 A—2 1 C、及び図2 2に示された基板1 5よりも薄くなっている。なお、保護テープ2 5の剥離はウェハ1 aを切断する工程(S 6 9)の前に行っても良い。

【0 0 9 9】 本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第1実施例と同様の理由により、ウェハ1 aが積層部4を有する場合においてもウェハ1 aを高精度に切断することができる。

また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、第2実施例と同様に、ウェハ1 aの基板1 5が薄くなるようにウェハ1 aの裏面2 1を研削している。これによって、切断起点領域8を起点としてより小さな力で、或いは特別な力を必要とせずにウェハ1 aをより精度良く切断することができる。

【0 1 0 0】 また、本実施例に係るレーザ加工方法では、第1実施例と同様に、ウェハ1 aに外力を印加することにより切断起点領域8を起点としてウェハ1 aを複数のチップ状部分2 4に切断している。これによって、切断起点領域8を起点としてウェハ1 aを容易に切断することができる。

【0 1 0 1】 以上、本発明の実施形態及び実施例について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態及び実施例に限定されないことはいうまでもない。

【0 1 0 2】 例えば、上記した実施形態及び実施例においては基板として半導体基板を用いているが、本発明は半導体基板に限らず、導電性基板や絶縁性基板を有するウェハに対しても好適に適用することができる。

産業上の利用可能性

【0 1 0 3】 以上説明したように、本発明に係るレーザ加工方法によれば、加

- 工対象物の表面に保護フィルムを装着することによって、加工対象物を裏面を上にして台上に載置することができるので、加工対象物の裏面から基板の内部にレーザー光を好適に照射することができる。そして、多光子吸収という現象により形成される改質領域でもって、加工対象物を切断すべき所望の切断予定ラインに沿った切断起点領域を基板の内部に形成し、この切断起点領域を起点として加工対象物を切断することができる。そして、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着してこれを伸張させることにより、切断された加工対象物の複数の部分を容易に分離することができる。すなわち、本レーザー加工方法によれば、加工対象物の表面にある積層部にレーザー光を直接照射せずに切断起点領域を形成できるとともに、切断起点領域を起点として基板を比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断された加工対象物を容易に分離することができる。従って、このレーザー加工方法によれば、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。



## 請求の範囲

1. 基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

5 前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記切断起点領域を起点として前記加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備える、レーザ加工方法。

10

2. 基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

15

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記加工対象物に外力を印加することにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。

20

3. 基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

25

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の前記裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によ

って、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザー光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断するとともに前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザー加工方法。

5

4. 半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザー加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザー光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザー光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザー光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記切断起点領域を起点として前記加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備える、レーザー加工方法。

10

15

5. 半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザー加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザー光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザー光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザー光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記加工対象物に外力を印加することにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザー加工方法。

20

25

6. 半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加

工対象物を切断するレーザー加工方法であって、

- 5 前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の前記裏面をレーザー光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザー光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザー光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断するとともに前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザー加工方法。
- 10 7. 前記加工対象物に前記切断起点領域を形成する前に、前記加工対象物の前記基板が薄くなるように前記加工対象物の前記裏面を研削する、請求項1～6のいずれか一項に記載のレーザー加工方法。
8. 前記伸張性のフィルムを前記加工対象物に装着した後、前記保護フィルムを除去する、請求項1～7のいずれか一項に記載のレーザー加工方法。
- 15 9. 前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分に分離した後、前記保護フィルムを除去する、請求項1～7のいずれか一項に記載のレーザー加工方法。

図1

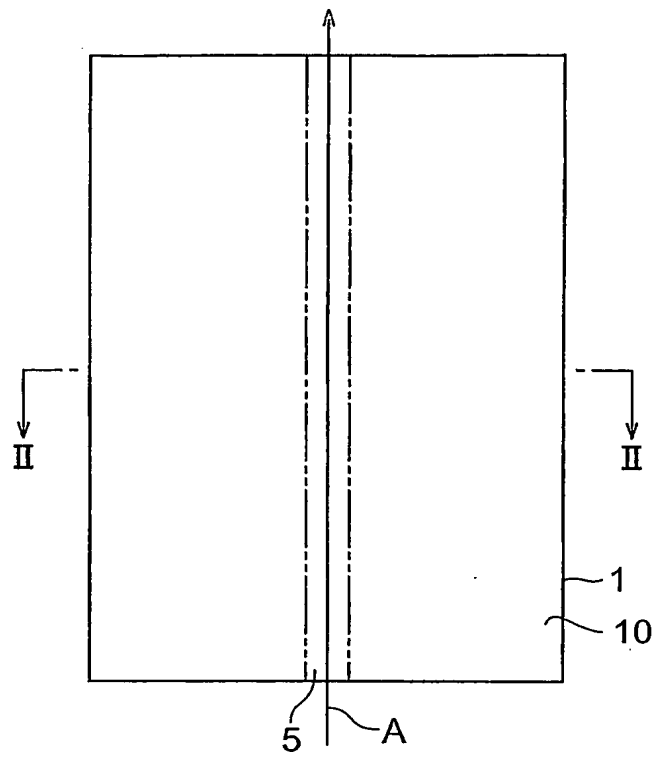


図2

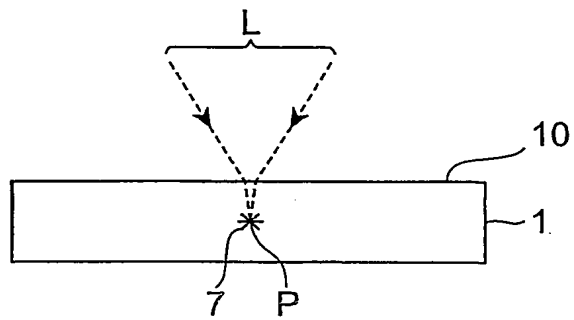


図3

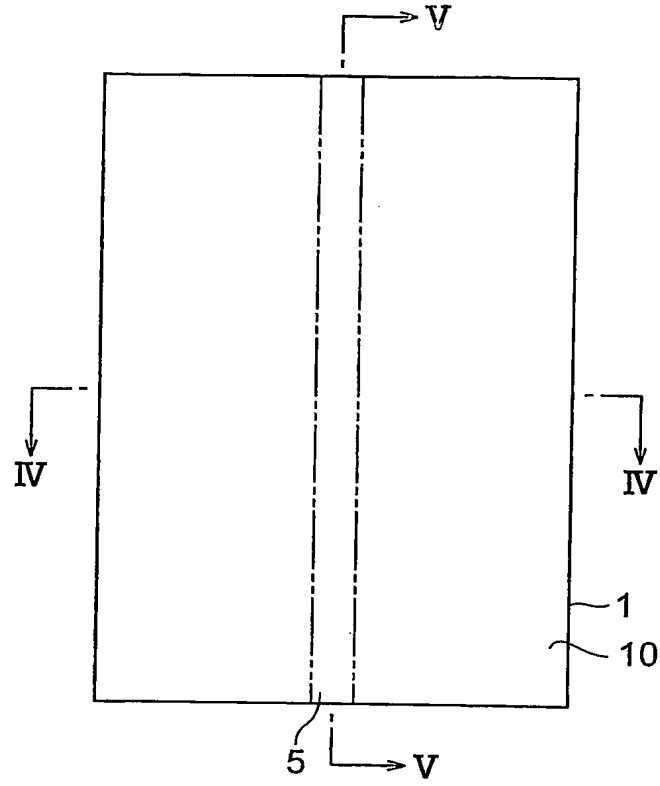


図4

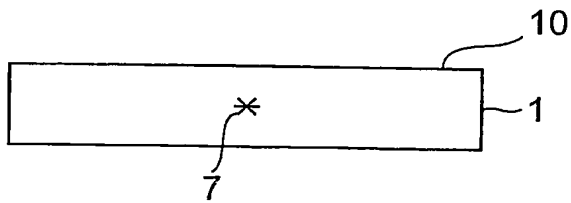


図5

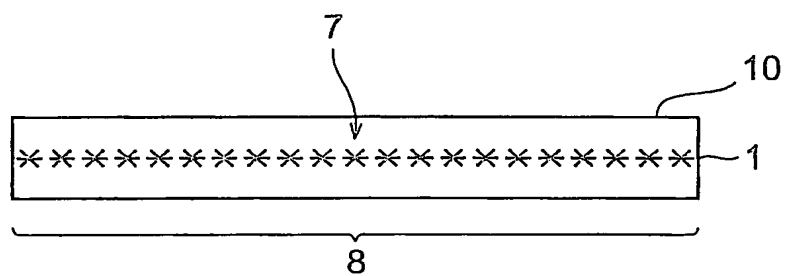


図6

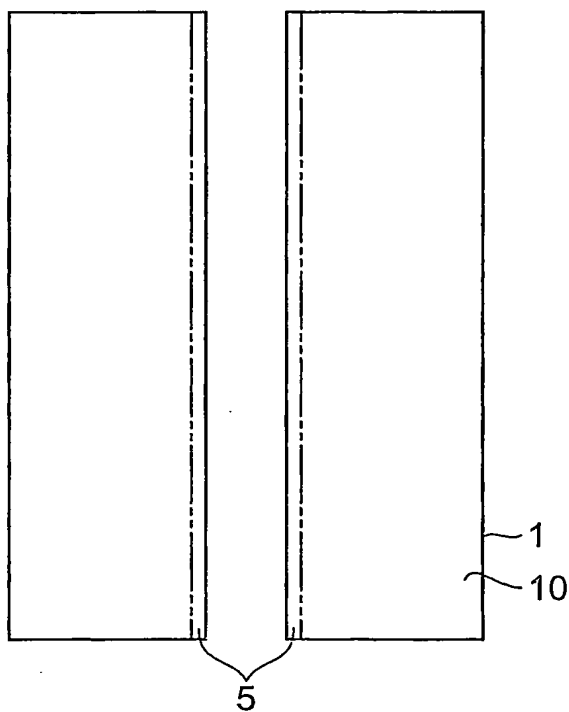


図7

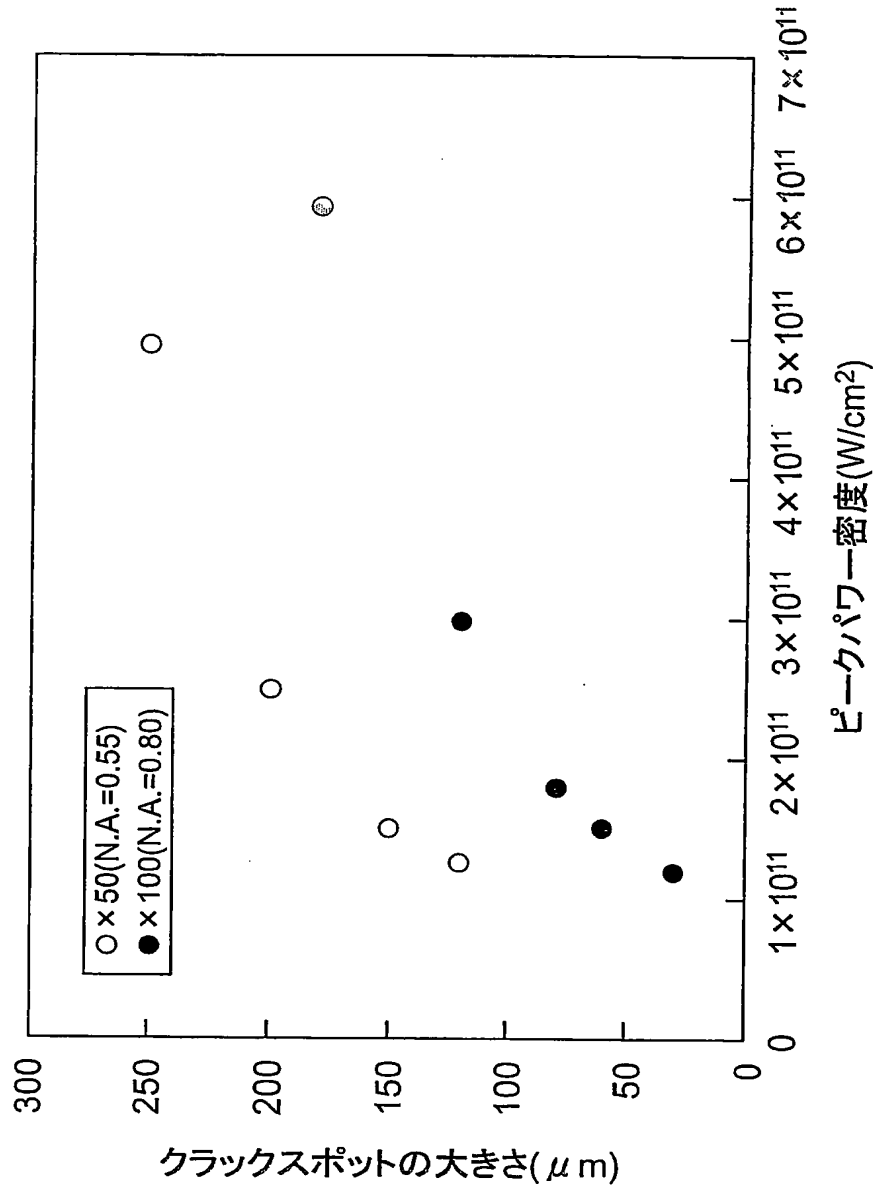


図8

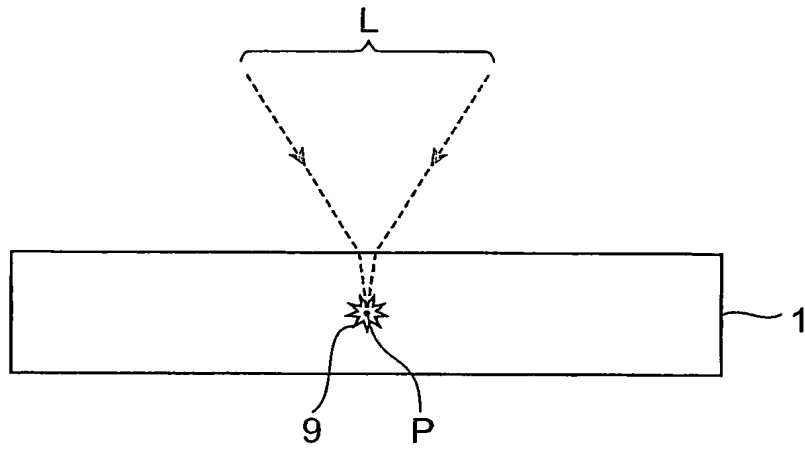


図9

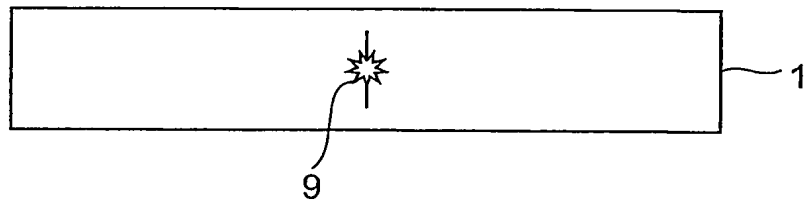




図10

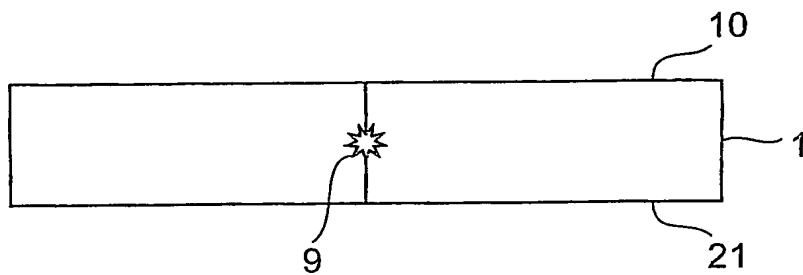
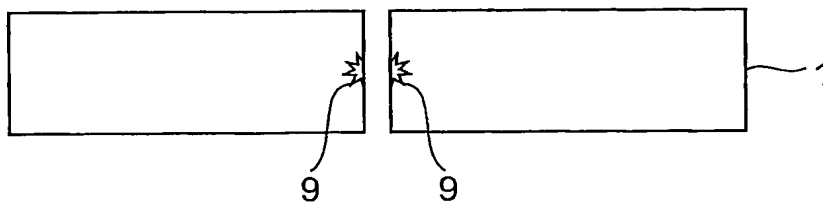


図11



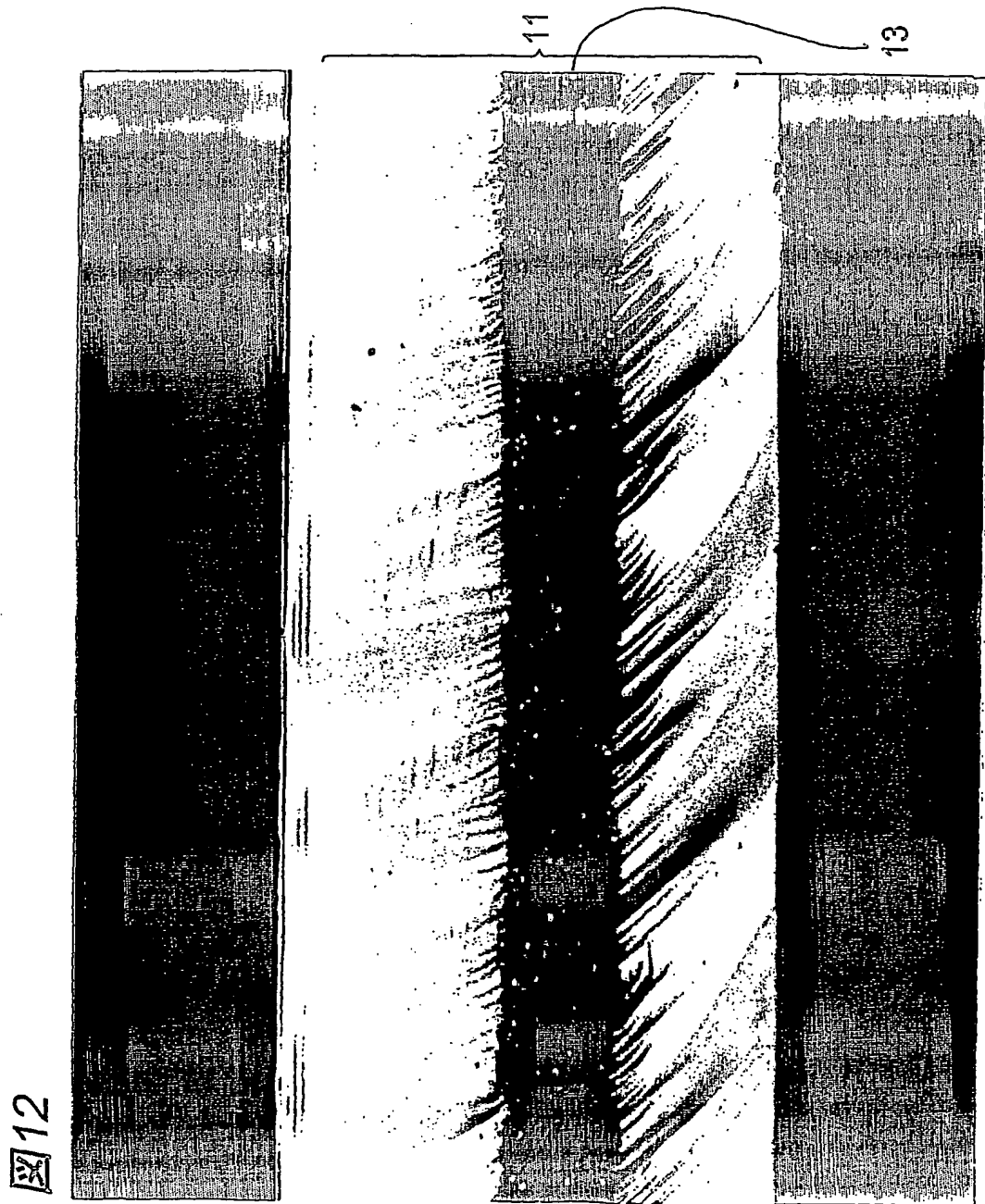


図12

7/24

差替え用紙（規則26）

図13

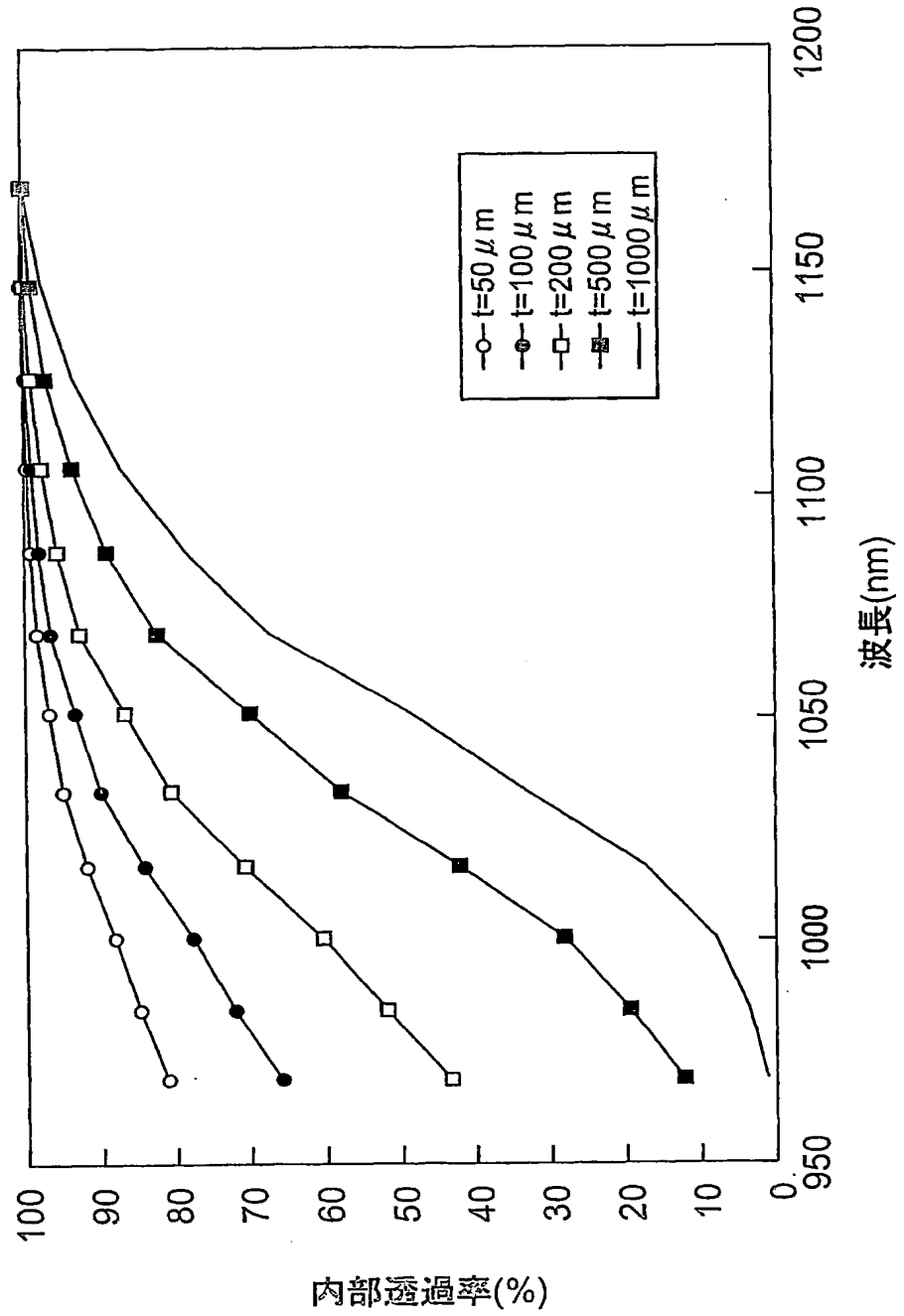


図14

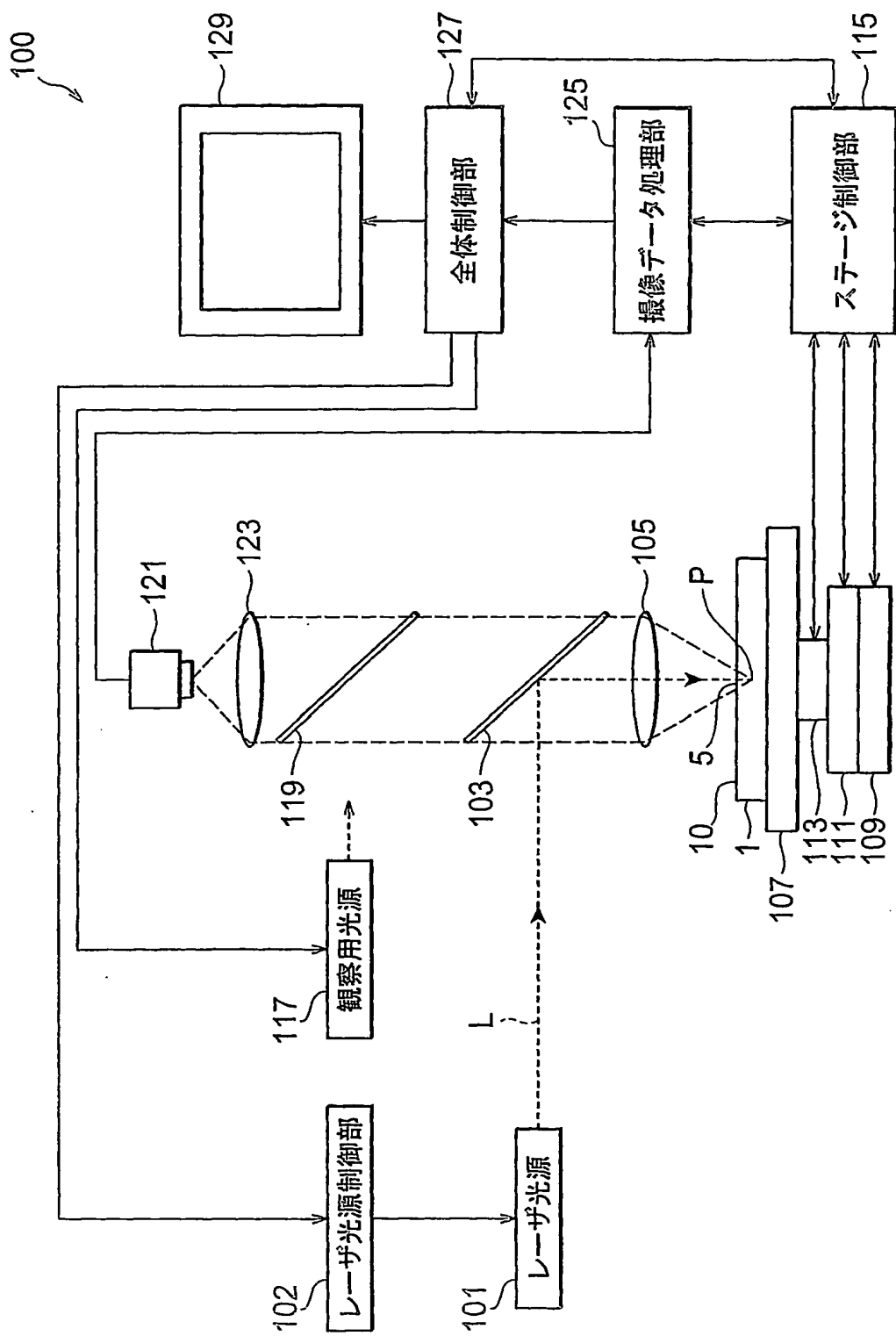


図15

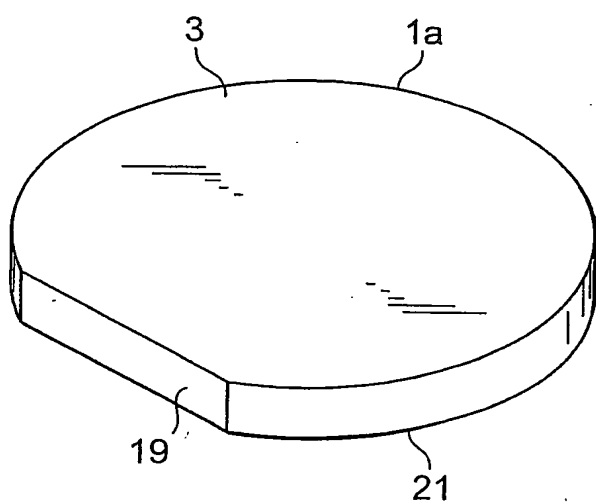


図 16

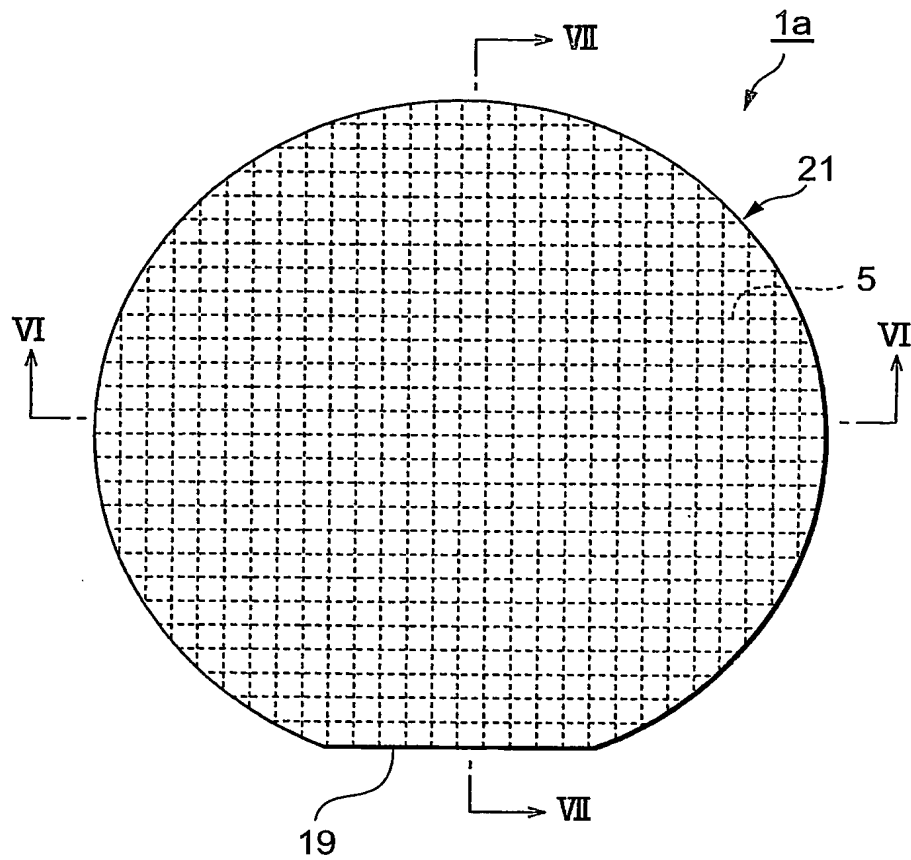


図17

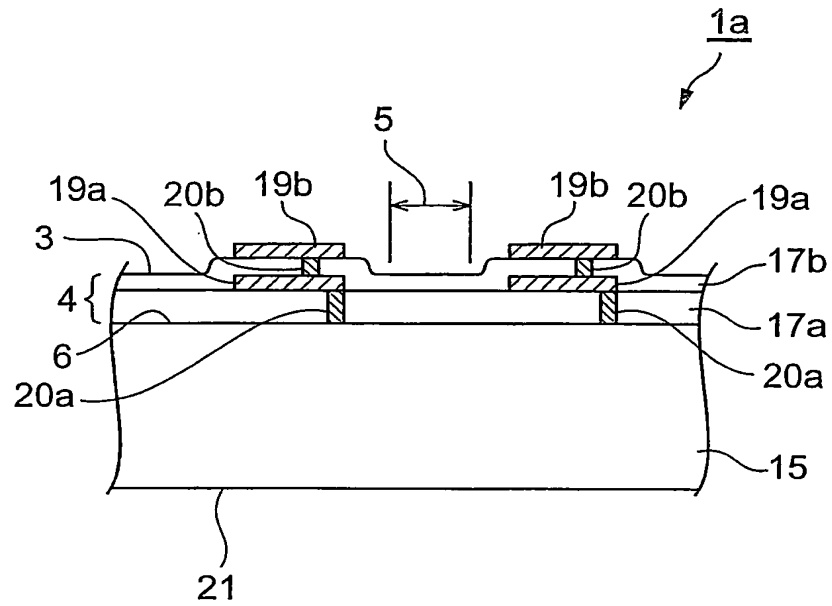


図18

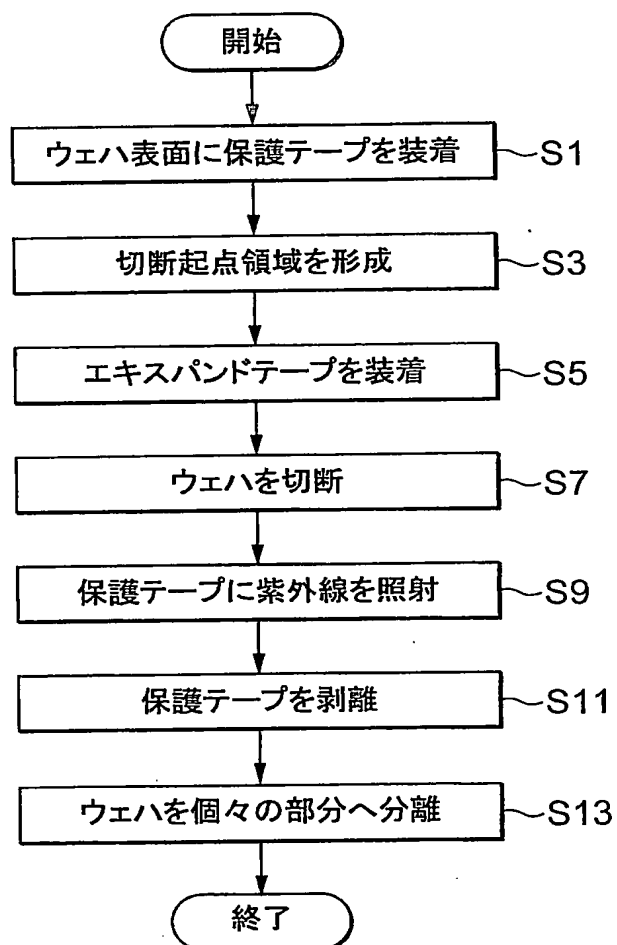




図19

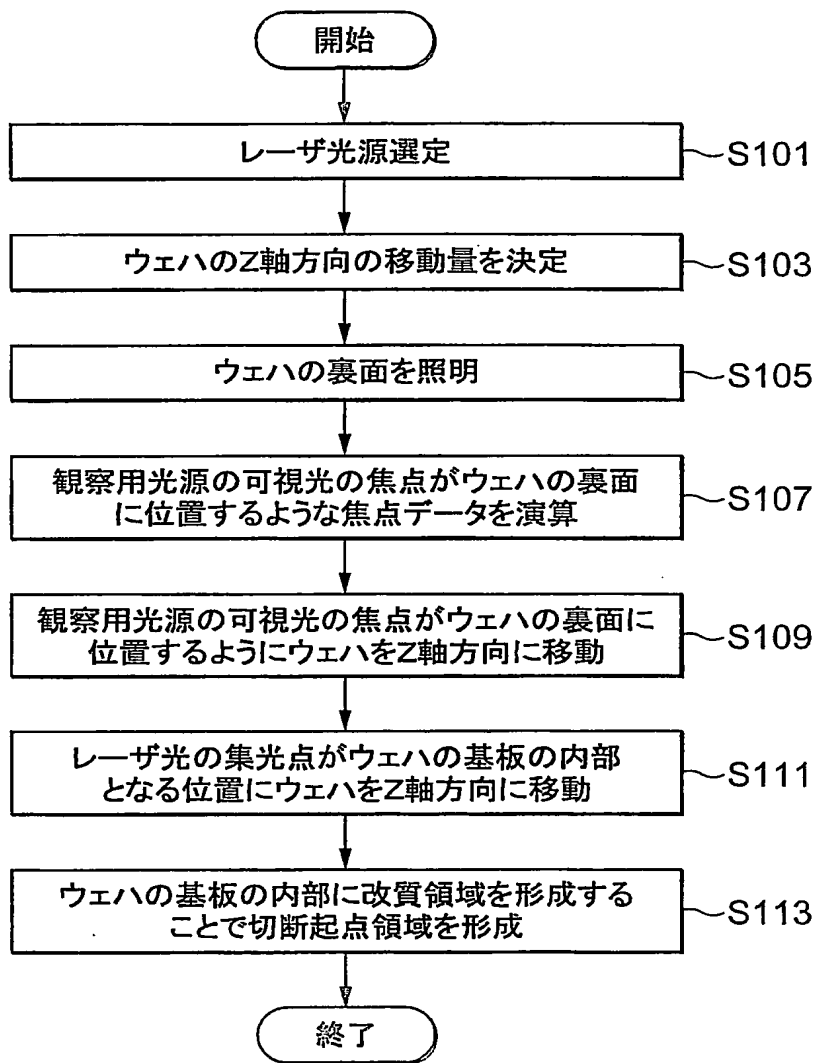


図20A

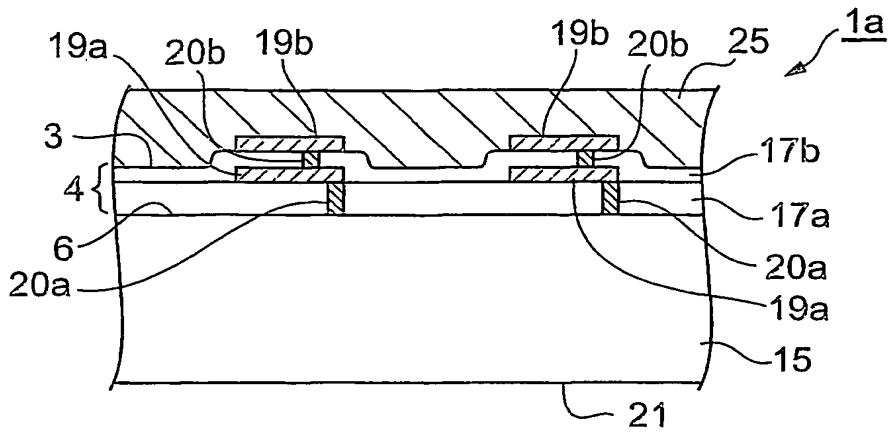


図20B

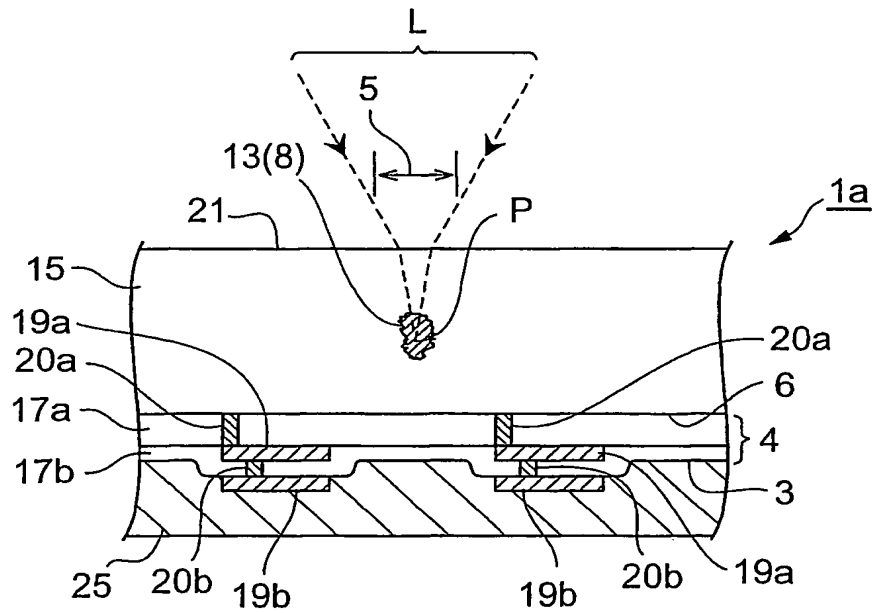


図20C

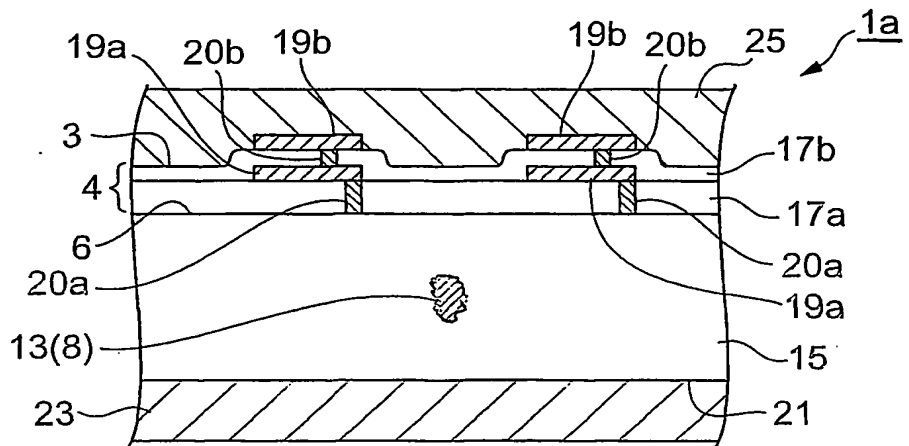


図21A

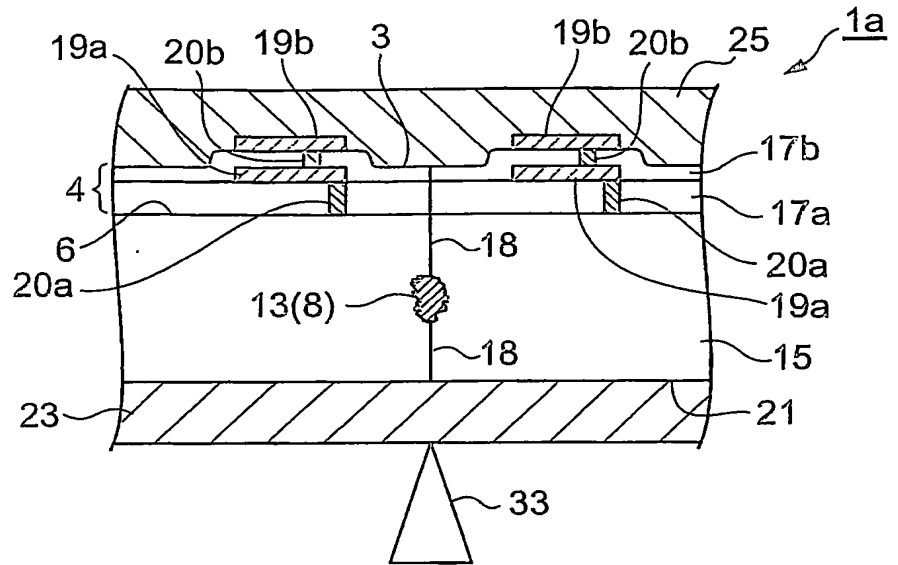


図21B

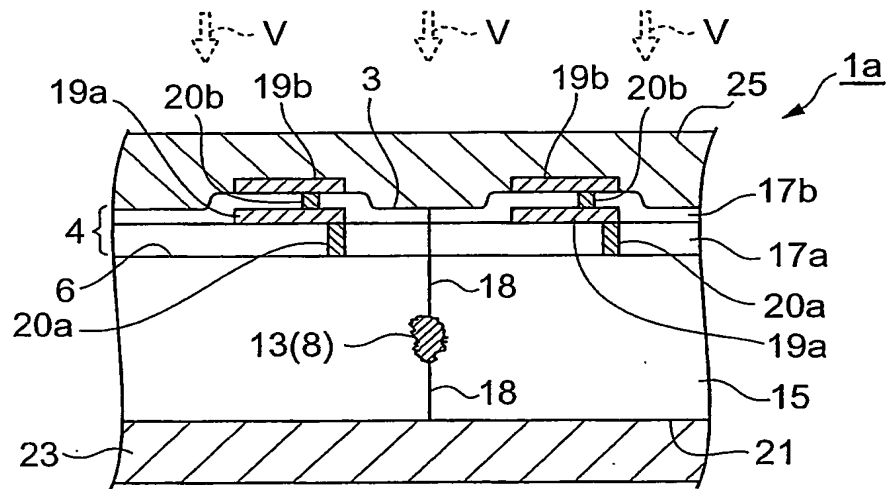
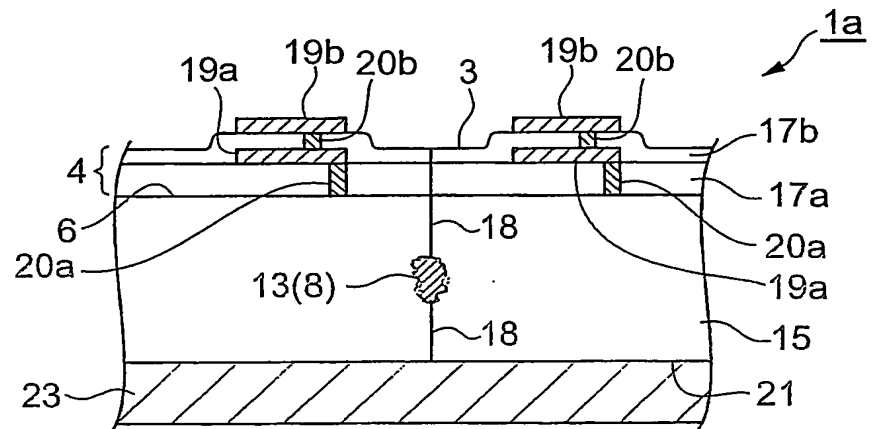
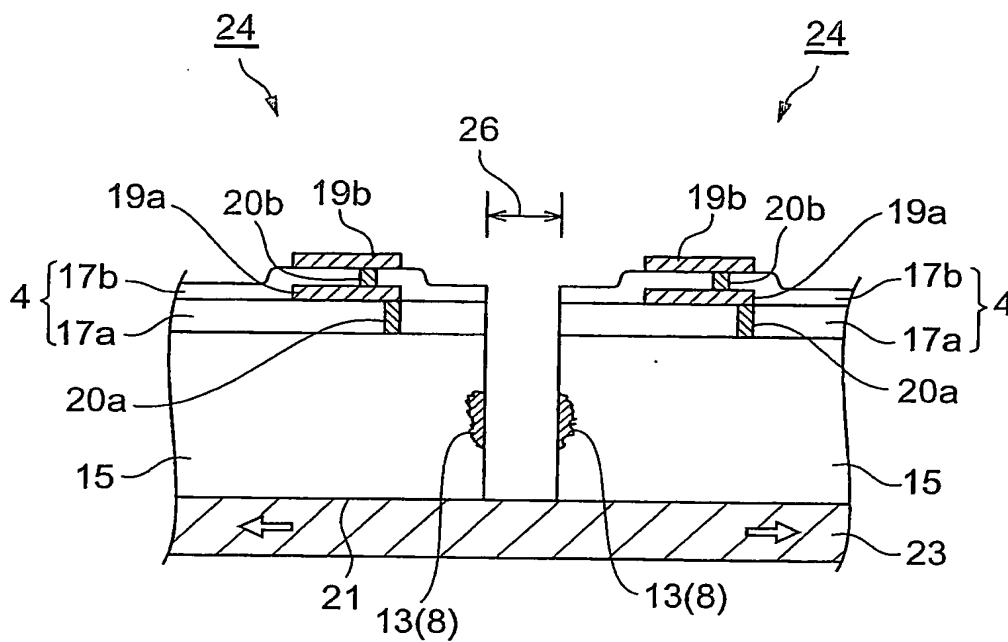


図21C



22



 23

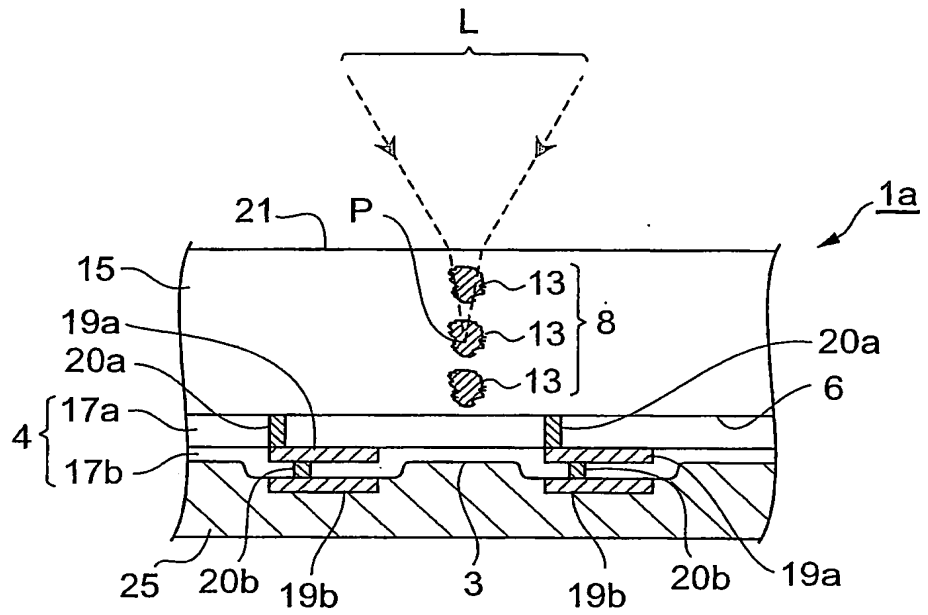


図24

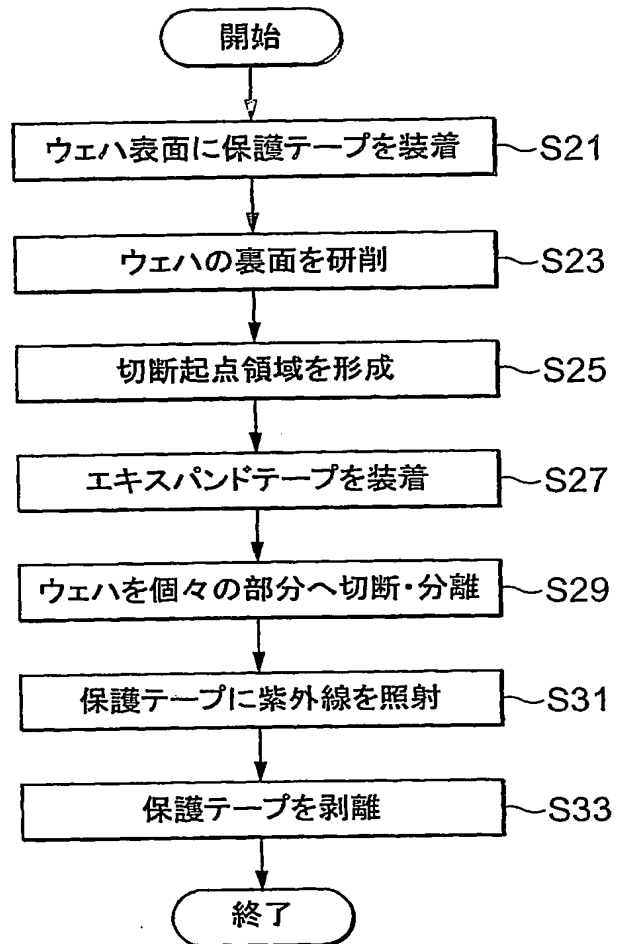


図25A

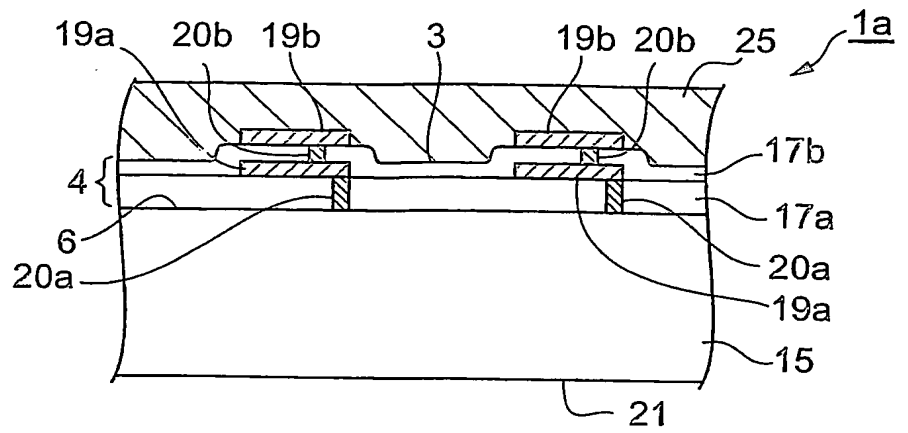


図25B

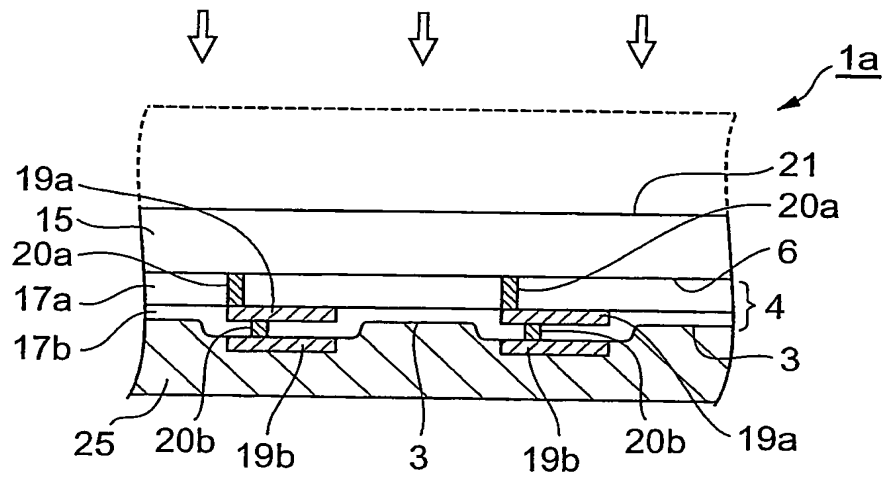
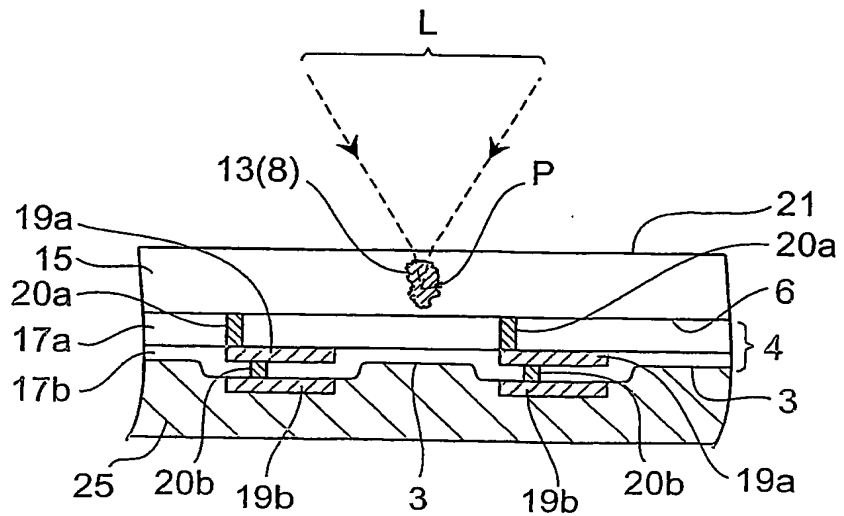
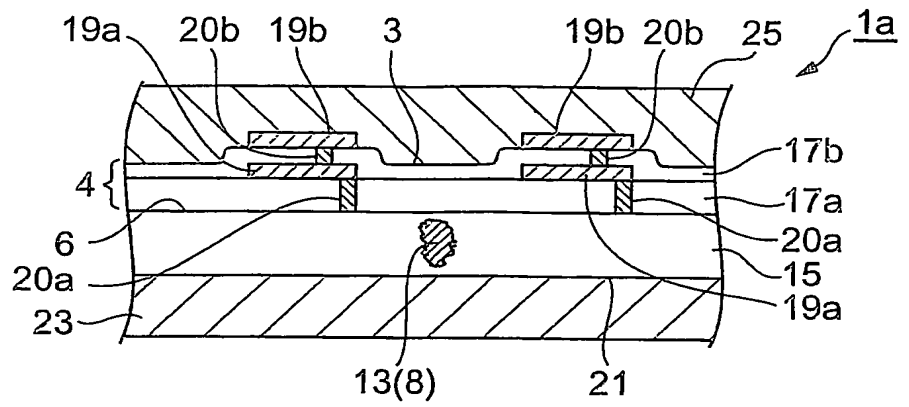


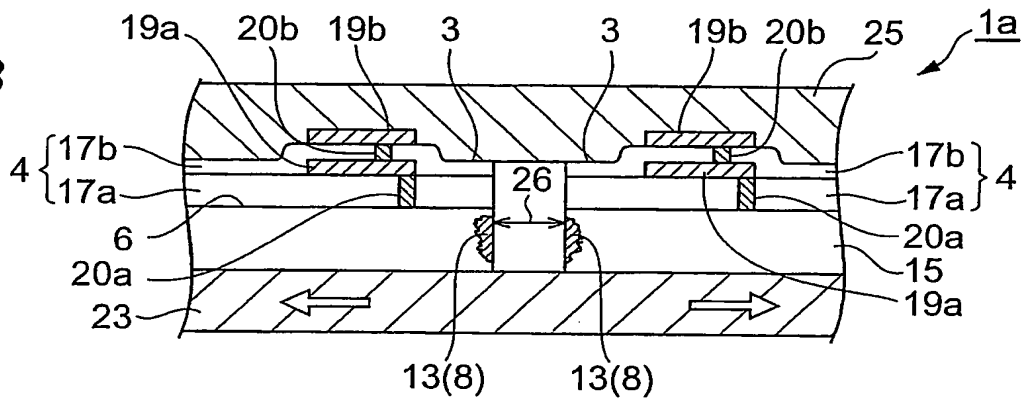
図25C



26A



26B



26C

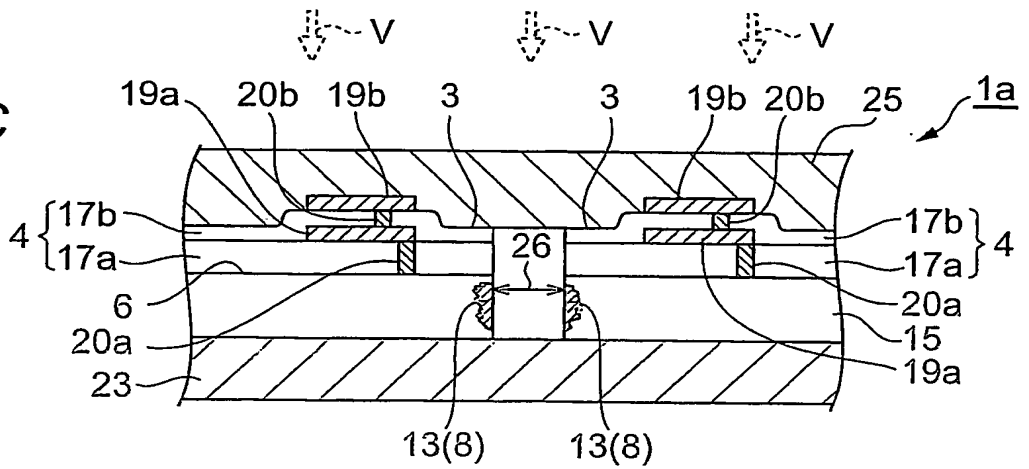




図27

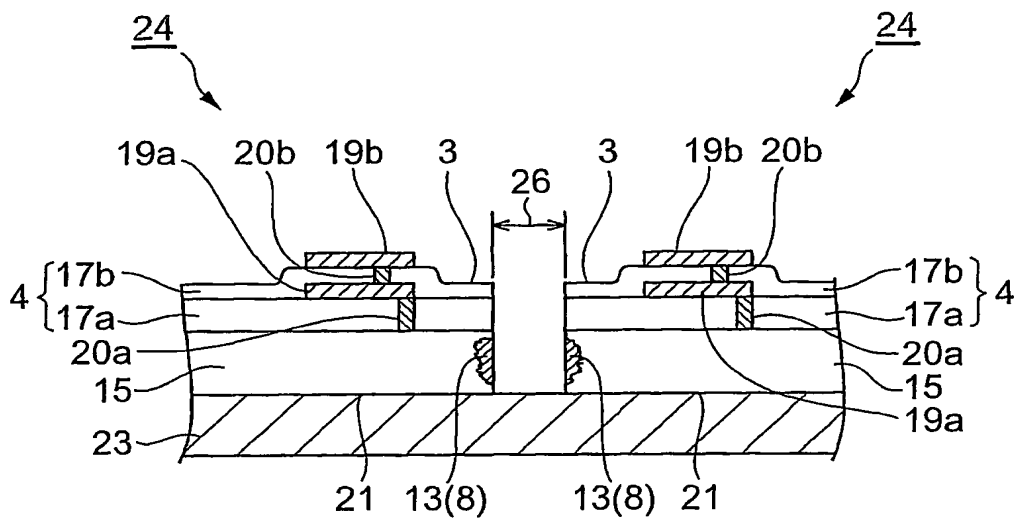


図28

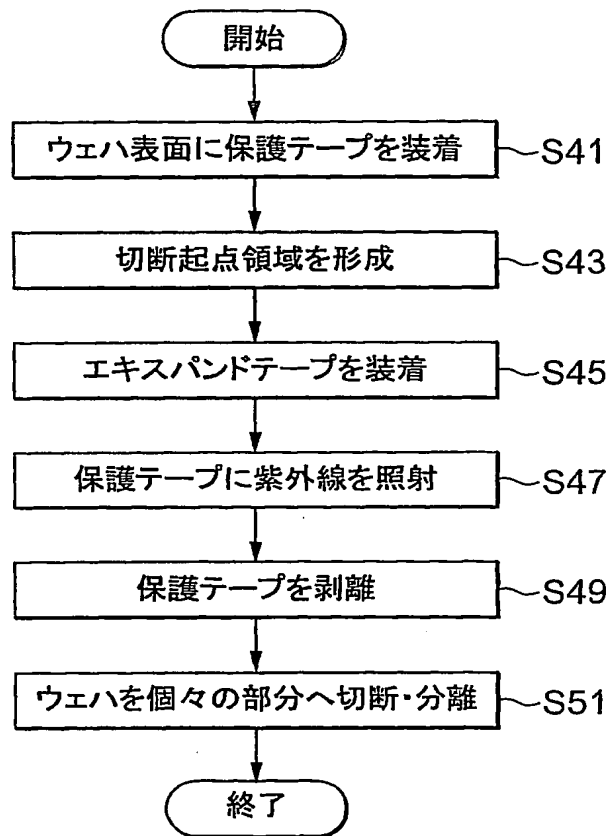
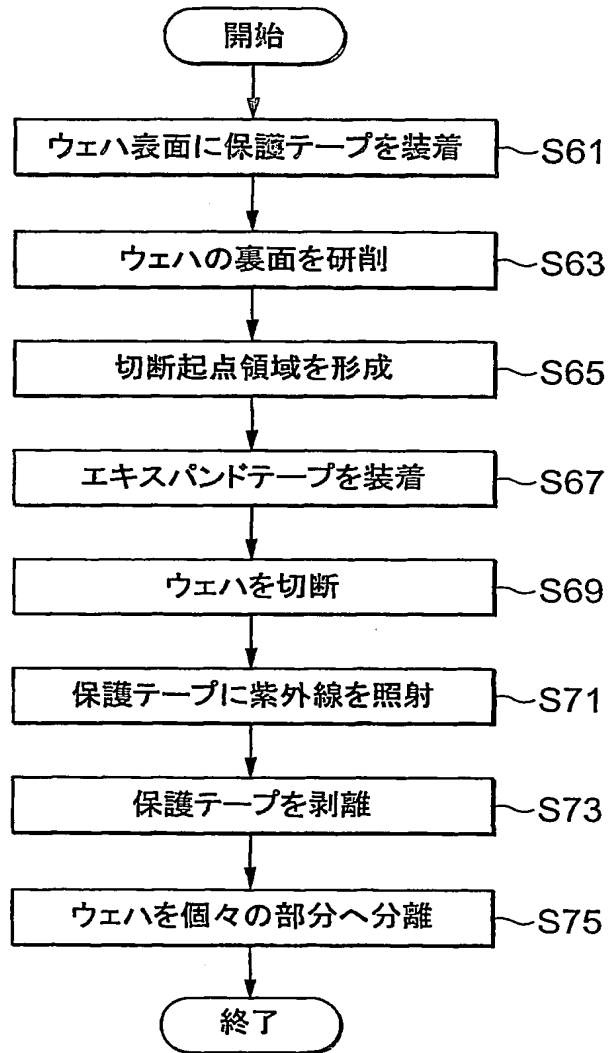


図29



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11626

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl<sup>7</sup> H01L21/301, B28D5/00, B23K26/38, B23K101:40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl<sup>7</sup> H01L21/301, B28D5/00, B23K26/38, B23K101:40

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2002-192370 A (Hamamatsu Photonics Kabushiki Kaisha), 10 July, 2002 (10.07.02), Full text; all drawings & EP 1338371 A1	1-9
Y	JP 9-17756 A (Toshiba Corp.), 17 January, 1997 (17.01.97), Par. Nos. [0002], [0026] to [0034] (Family: none)	1-9
Y	JP 2002-226796 A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 14 August, 2002 (14.08.02), Par. No. [0112]; Fig. 6 (Family: none)	1-9

Further documents are listed in the continuation of Box C.  See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search  
17 December, 2003 (17.12.03)

Date of mailing of the international search report  
13 January, 2004 (13.01.04)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11626

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 7-37840 A (NEC Corp.), 07 February, 1995 (07.02.95), Par. Nos. [0014] to [0019] (Family: none)	1-9
Y	JP 60-55640 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 30 March, 1985 (30.03.85), Page 2, upper right column, lines 1 to 18 (Family: none)	1-9
A	JP 11-221684 A (Hamamatsu Photonics Kabushiki Kaisha), 17 August, 1999 (17.08.99), (Family: none)	1-9

<p>A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))                  Int. C1<sup>7</sup> H01L21/301 B28D5/00 B23K26/38 B23K101:40</p>													
<p>B. 調査を行った分野                  調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))                  Int. C1<sup>7</sup> H01L21/301 B28D5/00 B23K26/38 B23K101:40</p>													
<p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの                  日本国実用新案公報 1922-1996年                  日本国公開実用新案公報 1971-2003年                  日本国登録実用新案公報 1994-2003年                  日本国実用新案登録公報 1996-2003年</p>													
<p>国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)</p>													
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求の範囲の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2002-192370 A (浜松ホトニクス株式会社) 2002.07.10, 全文, 全図 &amp; EP 1338371 A1</td> <td>1-9</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 9-17756 A (株式会社東芝) 1997.01.17, 【0002】, 【0026】 - 【0034】 (ファミリーなし)</td> <td>1-9</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2002-226796 A (日立化成工業株式会社) 2002.08.14, 【0112】, 図6 (ファミリーなし)</td> <td>1-9</td> </tr> </tbody> </table>		引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	Y	JP 2002-192370 A (浜松ホトニクス株式会社) 2002.07.10, 全文, 全図 & EP 1338371 A1	1-9	Y	JP 9-17756 A (株式会社東芝) 1997.01.17, 【0002】, 【0026】 - 【0034】 (ファミリーなし)	1-9	Y	JP 2002-226796 A (日立化成工業株式会社) 2002.08.14, 【0112】, 図6 (ファミリーなし)	1-9
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号											
Y	JP 2002-192370 A (浜松ホトニクス株式会社) 2002.07.10, 全文, 全図 & EP 1338371 A1	1-9											
Y	JP 9-17756 A (株式会社東芝) 1997.01.17, 【0002】, 【0026】 - 【0034】 (ファミリーなし)	1-9											
Y	JP 2002-226796 A (日立化成工業株式会社) 2002.08.14, 【0112】, 図6 (ファミリーなし)	1-9											
<p><input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p>													
<p>* 引用文献のカテゴリー                  「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの                  「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの                  「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)                  「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献                  「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献                  「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの                  「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの                  「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの                  「&amp;」 同一パテントファミリー文献</p>													
<p>国際調査を完了した日 17.12.03</p>	<p>国際調査報告の発送日 13.01.04</p>												
<p>国際調査機関の名称及びあて先                  日本国特許庁 (ISA/JP)                  郵便番号100-8915                  東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>	<p>特許庁審査官 (権限のある職員)                  紀本 孝                  3P 8815                  電話番号 03-3581-1101 内線 3363</p>												

## C (続き). 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 7-37840 A (日本電気株式会社) 1995. 02. 07, 【0014】 - 【0019】 (ファミリーなし)	1-9
Y	JP 60-55640 A (三洋電機株式会社) 1985. 03. 30, 第2頁右上欄第1-18行 (ファミリーなし)	1-9
A	JP 11-221684 A (浜松ホトニクス株式会社) 1999. 08. 17 (ファミリーなし)	1-9